

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2004年 8月 6日

出願番号
Application Number: 特願2004-231739

パリ条約による外国への出願
に用いる優先権の主張の基礎
となる出願の国コードと出願
番号

The country code and number
of your priority application,
to be used for filing abroad
under the Paris Convention, is

J P 2004-231739

出願人
Applicant(s): 株式会社村田製作所

2005年 8月17日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川



【書類名】	特許願
【整理番号】	MU12393-01
【提出日】	平成16年 8月 6日
【あて先】	特許庁長官殿
【国際特許分類】	H04B 1/44
【発明者】	
【住所又は居所】	京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田製作所内
【氏名】	上嶋 孝紀
【発明者】	
【住所又は居所】	京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田製作所内
【氏名】	中山 尚樹
【発明者】	
【住所又は居所】	京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田製作所内
【氏名】	原田 哲郎
【発明者】	
【住所又は居所】	京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田製作所内
【氏名】	小山 訓裕
【特許出願人】	
【識別番号】	000006231
【氏名又は名称】	株式会社村田製作所
【代理人】	
【識別番号】	100091432
【弁理士】	
【氏名又は名称】	森下 武一
【手数料の表示】	
【予納台帳番号】	007618
【納付金額】	16,000円
【提出物件の目録】	
【物件名】	特許請求の範囲 1
【物件名】	明細書 1
【物件名】	図面 1
【物件名】	要約書 1
【包括委任状番号】	9004894～

【請求項 1】

(A) アンテナ端子と送信側入力端子との間の信号経路と、前記アンテナ端子と受信側バランス出力端子との間の信号経路とを選択的に切り換えるためのスイッチと、

(B) 前記スイッチと前記送信側入力端子との間に配置され、インダクタ及びコンデンサを含む LC フィルタと、

(C) 前記スイッチと前記受信側バランス出力端子との間に配置された弾性表面波フィルタと、

(D) 前記弾性表面波フィルタと前記受信側バランス出力端子との間に配置され、インダクタ及びコンデンサを含む整合素子と、を備え、

前記スイッチ、LC フィルタ、弾性表面波フィルタ及び整合素子が複数の誘電体層を積層してなる積層体ブロックで一体化されてなること、

を特徴とする高周波複合部品。

【請求項 2】

前記整合素子のインダクタは前記積層体ブロックの第 1 領域に形成されており、前記 LC フィルタのインダクタ及びコンデンサは平面視で前記第 1 領域とは異なる第 2 領域に形成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の高周波複合部品。

【請求項 3】

前記整合素子のインダクタは前記積層体ブロックの表面に搭載されており、前記 LC フィルタのインダクタ及びコンデンサは前記積層体ブロックの内部に内蔵されていることを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 に記載の高周波複合部品。

【請求項 4】

前記整合素子のインダクタと前記 LC フィルタのインダクタ及びコンデンサの間にはグラウンド電極が配置されていることを特徴とする請求項 1 ないし請求項 3 のいずれかに記載の高周波複合部品。

【請求項 5】

前記 LC フィルタのコンデンサは前記積層体ブロックの最下層近辺に形成されていることを特徴とする請求項 1 ないし請求項 4 のいずれかに記載の高周波複合部品。

【請求項 6】

前記整合素子のインダクタ及びコンデンサは前記積層体ブロックの表面に形成されており、前記整合素子のインダクタは他の素子を介さずに前記整合素子のコンデンサに隣接配置されていることを特徴とする請求項 1 ないし請求項 5 のいずれかに記載の高周波複合部品。

【請求項 7】

前記弾性表面波フィルタは、バランス出力ポートを有するバランス型弾性表面波フィルタであって、前記整合素子のインダクタが前記バランス出力ポート間に並列接続されており、前記整合素子のコンデンサが前記バランス出力ポートに直列接続されていることを特徴とする請求項 1 ないし請求項 6 のいずれかに記載の高周波複合部品。

【請求項 8】

前記弾性表面波フィルタは、アンバランス出力ポートを有するアンバランス型弾性表面波フィルタであって、前記整合素子のインダクタ及びコンデンサは balan を兼ねていることを特徴とする請求項 1 ないし請求項 6 のいずれかに記載の高周波複合部品。

【請求項 9】

前記アンテナ端子の後段に、第 1 周波数帯の信号経路と、前記第 1 周波数帯とは異なる第 2 周波数帯の信号経路とを分岐するダイプレクサを備え、さらに、

前記第 1 周波数帯の信号経路における、(A) 前記アンテナ端子と第 1 送信側入力端子との間の信号経路と、前記アンテナ端子と第 1 受信側バランス出力端子との間の信号経路とを選択的に切り換えるための第 1 スイッチと、(B) 前記第 1 スイッチと前記第 1 送信側入力端子との間に配置され、インダクタ及びコンデンサを含む第 1 LC フィルタと、(C) 前記第 1 スイッチと前記第 1 受信側バランス出力端子との間に配置された第 1 弾性表

面波フィルタと、（L）前記第1弾性表面波フィルタと前記第1受信側バランヘ山力端との間に配置され、インダクタ及びコンデンサを含む第1整合素子と、

前記第2周波数帯の信号経路における、（E）アンテナ端子と第2送信側入力端子との間の信号経路と、前記アンテナ端子と第2受信側バラン出力端子との間の信号経路とを選択的に切り換えるための第2スイッチと、（F）前記第2スイッチと前記第2送信側入力端子との間に配置され、インダクタ及びコンデンサを含む第2LCフィルタと、（G）前記第2スイッチと前記第2受信側バラン出力端子との間に配置された第2弾性表面波フィルタと、（H）前記第2弾性表面波フィルタと前記第2受信側バラン出力端子との間に配置され、インダクタ及びコンデンサを含む第2整合素子と、を備え、

前記ダイプレクサ、第1・第2スイッチ、第1・第2LCフィルタ、第1・第2弾性表面波フィルタ及び第1・第2整合素子が複数の誘電体層を積層してなる積層体ブロックで一体化されてなること、

を特徴とする請求項1ないし請求項8のいずれかに記載の高周波複合部品。

【請求項10】

前記アンテナ端子の後段に、第1周波数帯の信号経路と、前記第1周波数帯とは異なる第2周波数帯及び第3周波数帯の信号経路とを分岐するダイプレクサを備え、さらに、

前記第1周波数帯の信号経路における、（A）前記アンテナ端子と第1送信側入力端子との間の信号経路と、前記アンテナ端子と第1受信側バラン出力端子との間の信号経路とを選択的に切り換えるための第1スイッチと、（B）前記第1スイッチと前記第1送信側入力端子との間に配置され、インダクタ及びコンデンサを含む第1LCフィルタと、（C）前記第1スイッチと前記第1受信側バラン出力端子との間に配置された第1弾性表面波フィルタと、（D）前記第1弾性表面波フィルタと前記第1受信側バラン出力端子との間に配置され、インダクタ及びコンデンサを含む第1整合素子と、

前記第2周波数帯の信号経路における、（E）アンテナ端子と第2送信側入力端子との間の信号経路と、前記アンテナ端子と第2・第3受信側バラン出力端子との間の信号経路とを選択的に切り換えるための第2スイッチと、（F）前記第2スイッチと前記第2送信側入力端子との間に配置され、インダクタ及びコンデンサを含む第2LCフィルタと、（G）前記第2スイッチと前記第2受信側バラン出力端子との間に配置された信号経路と、前記第2スイッチと前記第3受信側バラン出力端子との間に配置された信号経路とを分岐するデュプレクサと、（H）前記デュプレクサと前記第2受信側バラン出力端子との間に配置された第2弾性表面波フィルタと、（I）前記第2弾性表面波フィルタと前記第2受信側バラン出力端子との間に配置され、インダクタ及びコンデンサを含む第2整合素子と、（J）前記デュプレクサと前記第3受信側バラン出力端子との間に配置された第3弾性表面波フィルタと、（K）前記第3弾性表面波フィルタと前記第3受信側バラン出力端子との間に配置され、インダクタ及びコンデンサを含む第3整合素子と、を備え、

前記ダイプレクサ、第1・第2スイッチ、第1・第2LCフィルタ、デュプレクサ、第1・第2・第3弾性表面波フィルタ及び第1・第2・第3整合素子が複数の誘電体層を積層してなる積層体ブロックで一体化されてなること、

を特徴とする請求項1ないし請求項8のいずれかに記載の高周波複合部品。

【発明の名称】 高周波複合部品

【技術分野】

【0001】

本発明は、高周波複合部品、特に、複数の異なる移動体通信システムに利用可能な高周波複合部品に関する。

【背景技術】

【0002】

現在、ヨーロッパでは、移動体通信装置として、複数の周波数帯、例えば、1.8GHz帯を使用するDCSと900MHz帯を使用するGSMとで動作が可能なデュアルバンド携帯電話機が提案されている。

【0003】

図16は、一般的なデュアルバンド携帯電話機の構成の一部を示し、アンテナ1、ダイプレクサ2及び二つの信号経路DCS系3（1.8GHz帯）とGSM系4（900MHz）から構成されている。

【0004】

ダイプレクサ2は、送信の際にはDCS系3あるいはGSM系4からの送信信号を選択し、受信の際にはDCS系3あるいはGSM系4への受信信号を選択する。DCS系3は送信部Tx dと受信部Rx dとに分離する高周波スイッチ3 a、DCSの基本周波数を通過させるとともに、2次高調波及び3次高調波を減衰させるフィルタ3 bからなる。GSM系4も、同様に、送信部Tx gと受信部Rx gとに分離する高周波スイッチ4 a、GSMの基本周波数を通過させるとともに、3次高調波を減衰させるフィルタ4 bからなる。

【0005】

ところで、近年では、受信部に2本の信号端子を持つ平衡型（バランス出力型）の高周波複合部品が提供されており、このような平衡型ではLNA（ローノイズアンプ）とのインピーダンスマッチングが必要となる。

【0006】

特許文献1には、図17に示すように、バランス出力型の弾性表面波フィルタからなるバンドパスフィルタ5の平衡出力端子Rx間にインダクタ6を並列に配置することが開示されている。しかし、インダクタ6のみでは所望のインピーダンス（特に複素数）に設定することは困難である。本発明者の知見によると、さらにインピーダンスを下げるためには各平衡出力端子と直列にコンデンサを挿入したり、インピーダンスを上げるためにはコンデンサに加えていま一つのインダクタを平衡出力端子間に並列に挿入することが必要である。しかし、このような高周波複合部品とLNAとの間にさらにコンデンサやインダクタを別部品として後付けすることは、部品点数や実装面積の増加によって機器が大型化してしまうとともに、バンドパスフィルタ5とLNAとの間のマッチング調整がより複雑になってしまう。

【特許文献1】 特開2003-142981号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

そこで、本発明の目的は、高周波複合部品単体で所望のインピーダンスを容易に設定できてLNAとのマッチング調整が不要で、部品点数の低減、小型化が可能な高周波複合部品を提供することにある。

【0008】

また、本発明の他の目的は、前記目的を達成することに加えて、素子相互の干渉を防ぎ、特性の良好な高周波複合部品を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0009】

前記目的を達成するため、本発明に係る高周波複合部品は、

（Ａ）前記スイッチと前記送信側入力端子との間の信号経路と、前記入力端子と受信側バランス出力端子との間の信号経路とを選択的に切り換えるためのスイッチと、

（Ｂ）前記スイッチと前記送信側入力端子との間に配置され、インダクタ及びコンデンサを含むＬＣフィルタと、

（Ｃ）前記スイッチと前記受信側バランス出力端子との間に配置された弾性表面波フィルタと、

（Ｄ）前記弾性表面波フィルタと前記受信側バランス出力端子との間に配置され、インダクタ及びコンデンサを含む整合素子と、を備え、

前記スイッチ、ＬＣフィルタ、弾性表面波フィルタ及び整合素子が複数の誘電体層を積層してなる積層体ブロックで一体化されてなること、
を特徴とする。

【００１０】

本発明に係る高周波複合部品においては、弾性表面波フィルタと受信側バランス出力端子との間にインダクタ及びコンデンサを含む整合素子を備えているため、このインダクタとコンデンサを適宜組み合わせることで、受信側バランス出力端子のインピーダンスを自由に設定することが可能となる。しかも、このインダクタとコンデンサは他の回路部品とともに積層体ブロックで一体化されているため、インダクタやコンデンサをディスクリートでプリント基板上に配置する場合と比べてプリント基板上での実装面積を小さくすることができると共に、弾性表面波フィルタと整合素子との距離を最小限に抑え、フィルタと整合素子との間の損失を抑えて高周波特性を改善することができる。

【００１１】

ところで、前記スイッチ、ＬＣフィルタ、弾性表面波フィルタ及び整合素子を複数の誘電体層を積層してなる積層体ブロックで一体化する際に重要なのは、整合素子とＬＣフィルタとの間の干渉を防止できる配置とすることである。特に、整合素子のインダクタンスにはＱ値や安定性が高いことが要求される。

【００１２】

そこで、本発明に係る高周波複合部品において、整合素子のインダクタは積層体ブロックの第１領域に形成されており、ＬＣフィルタのインダクタ及びコンデンサは平面視で前記第１領域とは異なる第２領域に形成されていることが好ましい。

【００１３】

同様に、整合素子のインダクタは積層体ブロックの表面に搭載されており、ＬＣフィルタのインダクタ及びコンデンサは積層体ブロックの内部に内蔵されていることが好ましい。また、整合素子のインダクタとＬＣフィルタのインダクタ及びコンデンサとの間にはグラウンド電極が配置されていることが好ましい。あるいは、ＬＣフィルタのコンデンサは積層体ブロックの最下層近辺に形成されていることが好ましい。

【００１４】

整合素子のインダクタ及びコンデンサは積層体ブロックの表面に形成されており、整合素子のインダクタは他の素子を介さずに整合素子のコンデンサに隣接配置してもよい。

【００１５】

また、前記弾性表面波フィルタは、バランス出力ポートを有するバランス型弾性表面波フィルタであってもよく、あるいは、アンバランス出力ポートを有するアンバランス型弾性表面波フィルタであってもよい。バランス型である場合は、整合素子のインダクタがバランス出力ポート間に並列接続されており、整合素子のコンデンサがバランス出力ポートに直列接続されている。また、アンバランス型である場合は、整合素子のインダクタ及びコンデンサは balan を兼ねていることになる。

【００１６】

さらに、本発明に係る高周波複合部品は、二つの異なる周波数帯の信号処理に対応できるデュアルバンド対応型の高周波複合部品として構成することができる。このようなデュアルバンド対応型の高周波複合部品は、前記アンテナ端子の後段に、第１周波数帯の信号経路と、前記第１周波数帯とは異なる第２周波数帯の信号経路とを分岐するダイプレクサ

を備え、さらに、

前記第1周波数帯の信号経路における、(A)前記アンテナ端子と第1送信側入力端子との間の信号経路と、前記アンテナ端子と第1受信側バランス出力端子との間の信号経路とを選択的に切り換えるための第1スイッチと、(B)前記第1スイッチと前記第1送信側入力端子との間に配置され、インダクタ及びコンデンサを含む第1LCフィルタと、(C)前記第1スイッチと前記第1受信側バランス出力端子との間に配置された第1弾性表面波フィルタと、(D)前記第1弾性表面波フィルタと前記第1受信側バランス出力端子との間に配置され、インダクタ及びコンデンサを含む第1整合素子と、

前記第2周波数帯の信号経路における、(E)アンテナ端子と第2送信側入力端子との間の信号経路と、前記アンテナ端子と第2受信側バランス出力端子との間の信号経路とを選択的に切り換えるための第2スイッチと、(F)前記第2スイッチと前記第2送信側入力端子との間に配置され、インダクタ及びコンデンサを含む第2LCフィルタと、(G)前記第2スイッチと前記第2受信側バランス出力端子との間に配置された第2弾性表面波フィルタと、(H)前記第2弾性表面波フィルタと前記第2受信側バランス出力端子との間に配置され、インダクタ及びコンデンサを含む第2整合素子と、を備え、

前記ダイプレクサ、第1・第2スイッチ、第1・第2LCフィルタ、第1・第2弾性表面波フィルタ及び第1・第2整合素子が複数の誘電体層を積層してなる積層体ブロックで一体化されてなること、

を特徴とする。

【0017】

さらに、本発明に係る高周波複合部品は、三つの異なる周波数帯の信号処理に対応できるトリプルバンド対応型の高周波複合部品として構成することができる。このようなトリプルバンド対応型の高周波複合部品は、前記アンテナ端子の後段に、第1周波数帯の信号経路と、前記第1周波数帯とは異なる第2周波数帯及び第3周波数帯の信号経路とを分岐するダイプレクサを備え、さらに、

前記第1周波数帯の信号経路における、(A)前記アンテナ端子と第1送信側入力端子との間の信号経路と、前記アンテナ端子と第1受信側バランス出力端子との間の信号経路とを選択的に切り換えるための第1スイッチと、(B)前記第1スイッチと前記第1送信側入力端子との間に配置され、インダクタ及びコンデンサを含む第1LCフィルタと、(C)前記第1スイッチと前記第1受信側バランス出力端子との間に配置された第1弾性表面波フィルタと、(D)前記第1弾性表面波フィルタと前記第1受信側バランス出力端子との間に配置され、インダクタ及びコンデンサを含む第1整合素子と、

前記第2周波数帯の信号経路における、(E)アンテナ端子と第2送信側入力端子との間の信号経路と、前記アンテナ端子と第2・第3受信側バランス出力端子との間の信号経路とを選択的に切り換えるための第2スイッチと、(F)前記第2スイッチと前記第2送信側入力端子との間に配置され、インダクタ及びコンデンサを含む第2LCフィルタと、(G)前記第2スイッチと前記第2受信側バランス出力端子との間に配置された信号経路と、前記第2スイッチと前記第3受信側バランス出力端子との間に配置された信号経路とを分岐するデュプレクサと、(H)前記デュプレクサと前記第2受信側バランス出力端子との間に配置された第2弾性表面波フィルタと、(I)前記第2弾性表面波フィルタと前記第2受信側バランス出力端子との間に配置され、インダクタ及びコンデンサを含む第2整合素子と、(J)前記デュプレクサと前記第3受信側バランス出力端子との間に配置された第3弾性表面波フィルタと、(K)前記第3弾性表面波フィルタと前記第3受信側バランス出力端子との間に配置され、インダクタ及びコンデンサを含む第3整合素子と、を備え、

前記ダイプレクサ、第1・第2スイッチ、第1・第2LCフィルタ、デュプレクサ、第1・第2・第3弾性表面波フィルタ及び第1・第2・第3整合素子が複数の誘電体層を積層してなる積層体ブロックで一体化されてなること、

を特徴とする。

【発明を実施するための最良の形態】

【 0 0 1 0 】

以下、本発明に係る高周波複合部品の実施例について添付図面を参照して説明する。

【 0 0 1 9 】

(第1実施例、図1及び図2参照)

本第1実施例であるシングルバンド対応型の高周波複合部品は、図1のブロック図にその特徴的な構成を示すように、バランス型弾性表面波フィルタSAWの平衡出力部と受信側バランス出力端子R_xとの間に、インダクタLが並列に接続されているとともにコンデンサC₁、C₂がそれぞれ直列に接続されている。

【 0 0 2 0 】

詳しくは、図2の等価回路図に示すように、高周波複合部品は、概略、高周波スイッチ11と、LCフィルタ12と、バランス型弾性表面波フィルタSAWと、整合素子13とで構成されている。

【 0 0 2 1 】

高周波スイッチ11は、アンテナ端子ANTと送信側入力端子T_xとの間の信号経路と、アンテナ端子ANTと受信側バランス出力端子R_xとの間の信号経路とを選択的に切り換えるためのものである。LCフィルタ12は、高周波スイッチ11と送信側入力端子T_xとの間に配置され、インダクタGL_t1及びコンデンサを含んだローパスフィルタである。このローパスフィルタのコンデンサは、インダクタGL_t1と並列接続されたコンデンサGCと、グラウンドに接続される二つの接地コンデンサ(シャントコンデンサ)GC_u1、GC_u2からなっている。

【 0 0 2 2 】

整合素子13は、前述のように、弾性表面波フィルタSAWの平衡出力部と受信側バランス出力端子R_xとの間に、インダクタLを並列に接続するとともにコンデンサC₁、C₂をそれぞれ直列に接続したものである。

【 0 0 2 3 】

また、本第1実施例において、前記高周波スイッチ11、LCフィルタ12、弾性表面波フィルタSAW及び整合素子13は、複数の誘電体層を積層してなる積層体ブロックで一体化されている。

【 0 0 2 4 】

シングルバンド対応型である本第1実施例の高周波複合部品は、以下に説明するデュアルバンド対応型である第2・第3実施例の高周波複合部品及びトリプルバンド対応型である第4実施例の高周波複合部品にその一部として含まれるものである。従って、本第1実施例のより詳細な構成及び動作は以下に説明する第2・第3・第4実施例によって明らかにされる。

【 0 0 2 5 】

(第2実施例、図3～図8参照)

本第2実施例である高周波複合部品は、図3のブロック図にその特徴的な構成を示すように、GSM系及びDCS系を備えたデュアルバンド対応型の高周波複合部品(フロントエンドモジュール)であり、バランス型弾性表面波フィルタSAW_g、SAW_dの平衡出力部と受信側バランス出力端子R_{xg}、R_{xd}との間に、それぞれインダクタL_g、L_dが並列に接続されているとともにコンデンサC_{1g}、C_{2g}及びC_{1d}、C_{2d}がそれぞれ直列に接続されている。

【 0 0 2 6 】

詳しくは、図4の等価回路図に示すように、高周波複合部品は、アンテナ端子ANTの後段に、GSM系の信号経路と、DCS系の信号経路とを分岐するダイプレクサ20を備えている。さらに、GSM系は第1高周波スイッチ11_Gと第1LCフィルタ12_Gとバランス型第1弾性表面波フィルタSAW_gと第1整合素子13_Gとを備えている。DCS系も、同様に、第2高周波スイッチ11_Dと第2LCフィルタ12_Dとバランス型第2弾性表面波フィルタSAW_dと第2整合素子13_Dとを備えている。

【 0 0 2 7 】

第1高周波スイッチ11Gは、アンテナ端子ANTと第1送信側入力端子Txgとの間の信号経路と、アンテナ端子ANTと第1受信側バランス出力端子Rxgとの間の信号経路とを選択的に切り換える。第1LCフィルタ12Gは、第1高周波スイッチ11Gと第1送信側入力端子Txgとの間に配置されている。第1弾性表面波フィルタSAWgは第1高周波スイッチ11Gと第1受信側バランス出力端子Rxgとの間に配置されている。

【0028】

第1整合素子13Gは、インダクタLgを第1弾性表面波フィルタSAWg側に並列に接続し、コンデンサC1g、C2gをインダクタLgと受信側バランス出力端子Rxgとの間にそれぞれ直列に接続したものである。

【0029】

第2高周波スイッチ11Dは、アンテナ端子ANTと第2送信側入力端子Tx dとの間の信号経路と、アンテナ端子ANTと第2受信側バランス出力端子Rx dとの間の信号経路とを選択的に切り換える。第2LCフィルタ12Dは、第2高周波スイッチ11Dと第2送信側入力端子Tx dとの間に配置されている。第2弾性表面波フィルタSAW dは第2高周波スイッチ11Dと第2受信側バランス出力端子Rx dとの間に配置されている。

【0030】

第2整合素子13Dは、インダクタL dを第2弾性表面波フィルタSAW d側に並列に接続し、コンデンサC1 d、C2 dをインダクタL dと受信側バランス出力端子Rx dとの間にそれぞれ直列に接続したものである。

【0031】

ダイプレクサ20は、送信の際にはDCS系あるいはGSM系からの送信信号を選択し、受信の際にはDCS系あるいはGSM系への受信信号を選択する。ダイプレクサ20の第1ポートP11にはアンテナ端子ANTが、第2ポートP12には第1高周波スイッチ11Gの第1ポートP31g、第3ポートP13には第2高周波スイッチ11Dの第1ポートP31 dがそれぞれ接続されている。

【0032】

GSM系において、第1高周波スイッチ11Gの第2ポートP32gには第1LCフィルタ12Gの第1ポートP21gが接続され、第3ポートP33gには第1弾性表面波フィルタSAWgが接続されている。第1LCフィルタ12Gの第2ポートP22gには第1送信側入力端子Txgが接続されている。

【0033】

DCS系において、第2高周波スイッチ11Dの第2ポートP32 dには第2LCフィルタ12Dの第1ポートP21 dが接続され、第3ポートP33 dには第2弾性表面波フィルタSAW dが接続されている。第2LCフィルタ12Dの第2ポートP22 dには第2送信側入力端子Tx dが接続されている。

【0034】

ダイプレクサ20は、インダクタLt1、Lt2及びコンデンサCc1、Cc2、Ct1、Ct2、Cu1で構成されている。第1ポートP11と第2ポートP12との間にインダクタLt1とコンデンサCt1とからなる並列回路が接続され、この並列回路の第2ポートP12側がコンデンサCu1を介して接地される。また、第1ポートP11と第3ポートP13との間にはコンデンサCc1、Cc2が直列接続され、それらの接続点がインダクタLt2及びコンデンサCt2を介して接地される。

【0035】

第1高周波スイッチ11Gは、スイッチング素子であるダイオードGD1、GD2、インダクタGSL1、GSL2、コンデンサGC5、GC6及び抵抗RGで構成されている。第1ポートP31gと第2ポートP32gとの間に、アノードが第1ポートP31g側になるようにダイオードGD1が接続され、カソードはインダクタGSL1を介して接地される。ダイオードGD2はカソードがインダクタGSL2を介して第1ポートP31gに接続され、アノードがコンデンサGC5を介して接地される。ダイオードGD2とコンデンサGC5との接続点に抵抗RGを介して制御端子Vc1が接続されている。また、ダ

・ 11ポートG L 2のポートと第3ポート1 3 3との接続点はコンデンサG C u 1を介して接地される。

【0036】

第2高周波スイッチ1 1 Dは、スイッチング素子であるダイオードD D 1、D D 2、インダクタD S L 1、D S L 2、D S L t、コンデンサD C 6、D C 7、D C t 1及び抵抗R Dで構成されている。第1ポートP 3 1 dと第2ポートP 3 2 dとの間に、アノードが第1ポートP 3 1 d側になるようにダイオードD D 1が接続され、カソードはインダクタD S L 1を介して接地される。また、第1ポートP 3 1 dと第2ポートP 3 2 dとの間には、コンデンサD C t 1とインダクタD S L tの直列回路がダイオードD D 1とは並列に接続されている。ダイオードD D 2はカソードがインダクタD S L 2を介して第1ポートP 3 1 dに接続され、アノードがコンデンサD C 5を介して接地される。ダイオードD D 2とコンデンサD C 5との接続点に抵抗R Dを介して制御端子V c 2が接続されている。また、ダイオードD D 2のカソードはコンデンサD C 6を介して第3ポートP 3 3 dに接続され、カソードとコンデンサD C 6との接続点はコンデンサD C 7を介して接地される。

【0037】

第1LCフィルタ1 2 Gは、第1ポートP 2 1 gと第2ポートP 2 2 gとの間にインダクタG L t 1とコンデンサG C c 1の並列回路を接続したものである。インダクタG L t 1の両端はそれぞれコンデンサG C u 1、G C u 2を介して接地される。

【0038】

第2LCフィルタ1 2 Dは、第1ポートP 2 1 dと第2ポートP 2 2 dとの間に、インダクタD L t 1とコンデンサD C c 1の並列回路及びインダクタD L t 2とコンデンサD C c 2の並列回路を直列に接続したものである。インダクタD L t 1の両端はそれぞれコンデンサD C u 1、D C u 2を介して接地される。

【0039】

図5～図7は、本第2実施例である高周波複合部品のセラミック多層基板を構成する各シート層上にスクリーン印刷などで形成されたコンデンサ電極、ストリップライン電極などを示している。セラミック多層基板は酸化バリウム、酸化アルミニウム、シリカを主成分としたセラミックスからなる第1～第17シート層6 1 a～6 1 qを下から順次積層し、1000℃以下の温度で焼成することにより形成される。

【0040】

第1シート層6 1 aには種々の外部接続用端子電極が形成されている。第2シート層6 1 bにはグラウンド電極G 1が形成され、第3シート層6 1 cにはコンデンサG C u 1、G C u 2、C t 2、G C 5の電極が形成され、グラウンド電極G 1とでキャパシタンスを形成している。第4シート層6 1 dにはグラウンド電極G 2が形成され、第5シート層6 1 eにはコンデンサD C u 1、D C u 2の電極が形成され、グラウンド電極G 2とでキャパシタンスを形成している。

【0041】

第7・第9シート層6 1 g、6 1 iにはストリップライン電極によってインダクタL t 1、L t 2、D L t 1、D L t 2、G L t 1、D S L 1、D S L 2が形成され、それぞれがビアホールにて接続されている。さらに、第11シート層6 1 kにはストリップライン電極によってインダクタL t 1、L t 2、D L t 1、D L t 2、G L t 1、G S L 2が形成され、それぞれがビアホールにて下層の同種の電極と接続されている。

【0042】

第12シート層6 1 lにはコンデンサC t 1、D C c 1の電極が形成され、第13シート層6 1 mにはコンデンサC t 1、C c 1、D C t 1、G C c 1の電極及びグラウンド電極G 3が形成されている。第14シート層6 1 nにはコンデンサC c 1、D C t 1、G C c 1、D C 5の電極が形成されている。第15シート層6 1 oにはコンデンサC c 2、D C t 1の電極及びグラウンド電極G 4が形成されている。

【0043】

第1インポート層014の表面は、図6に示すように、セラミック多層基板50の表面であって、種々の接続用端子電極が形成されている。そして、その表面には、第1・第2弾性表面波フィルタSAWg、SAWd、ダイオードGD1、GD2、DD1、DD2が搭載され、さらに、第1整合素子13Gを構成するインダクタLg、コンデンサC1g、C2g、第2整合素子13Dを構成するインダクタLd、コンデンサC1d、C2dが搭載されている。さらに、セラミック多層基板50の表面には、抵抗RG、RDが搭載され、インダクタDSL1、DSLt、GSL1が搭載されている。

【0044】

ここで、図4に示した回路構成を有する高周波複合部品の動作について説明する。まず、DCS系（1.8MHz帯）の送信信号を送信する場合には、第2高周波スイッチ11Dにおいて制御端子Vc2に、例えば3Vを印加してダイオードDD1、DD2をオンすることにより、DCS系の送信信号が第2LCフィルタ12D、第2高周波スイッチ11D及びダイプレクサ20を通過し、ダイプレクサ20の第1ポートP11に接続されたアンテナ端子ANTから送信される。

【0045】

この際、GSM系の第1高周波スイッチ11Gにおいて制御端子Vc1に、例えば0Vを印加してダイオードGD1をオフすることにより、GSM系の送信信号が送信されないようにしている。また、ダイプレクサ20を接続することにより、DCS系の送信信号がGSM系の第1送信側入力端子Txg及び第1受信側バランス出力端子Rxgに回り込まないようにしている。さらに、DCS系の第2LCフィルタ12DではDCS系の2次高調波及び3次高調波を減衰させている。

【0046】

次いで、GSM系（900MHz帯）の送信信号を送信する場合には、第1高周波スイッチ11Gにおいて制御端子Vc1に、例えば3Vを印加してダイオードGD1、GD2をオンすることにより、GSM系の送信信号が第1LCフィルタ12G、第1高周波スイッチ11G及びダイプレクサ20を通過し、ダイプレクサ20の第1ポートP11に接続されたアンテナ端子ANTから送信される。

【0047】

この際、DCS系の第2高周波スイッチ11Dにおいて制御端子Vc2に、例えば0Vを印加してダイオードDD1をオフすることにより、DCS系の送信信号が送信されないようにしている。また、ダイプレクサ20を接続することにより、GSM系の送信信号がDCS系の第2送信側入力端子Tx d及び第2受信側バランス出力端子Rx dに回り込まないようにしている。

【0048】

さらに、ダイプレクサ20のコンデンサCt1、インダクタLt1及びシャントコンデンサCu1からなるローパスフィルタにてGSM系の2次高調波を減衰させ、GSM系の第1LCフィルタ12GではGSM系の3次高調波を減衰させている。

【0049】

次いで、DCS系及びGSM系の受信信号を受信する場合には、DCS系の第2高周波スイッチ11Dにおいて制御端子Vc2に、例えば0Vを印加してダイオードDD1、DD2をオフし、GSM系の第1高周波スイッチ11Gにおいて制御端子Vc1に0Vを印加してダイオードGD1、GD2をオフすることにより、DCS系の受信信号がDCS系の第2送信側入力端子Tx dに、GSM系の受信信号がGSM系の第1送信側入力端子Txgに、それぞれ回り込まないようにし、アンテナ端子ANTから入力した信号をそれぞれDCS系の受信側バランス出力端子Rx d、GSM系の受信側バランス出力端子Rxgに出力する。

【0050】

また、ダイプレクサ20を接続することにより、DCS系の受信信号がGSM系に、GSM系の受信信号がDCS系に、それぞれ回り込まないようにしている。

【0051】

平衡型大抵例の同相収束ロ部面においては、弾性表面波フィルタSAWg, SAWdと受信側バランス出力端子Rxg, Rxdとの間に、インダクタLg, Ld及びコンデンサC1g, C2g, C1d, C2dを含む整合素子13G, 13Dを備えているため、このインダクタとコンデンサを適宜組み合わせることで、受信側バランス出力端子Rxg, Rxdのインピーダンスを自由に設定することが可能となる。そして、コンデンサを出力端子Rxg, Rxd側に挿入することにより、インピーダンスを下げる調整が可能である。

【0052】

また、このインダクタLg, LdとコンデンサC1g, C2g, C1d, C2dは他の回路部品とともにセラミック積層基板で一体化されているため、この種のインダクタやコンデンサをディスクリットでプリント基板上に配置する場合と比べてプリント基板上での実装面積を小さくすることができると共に、弾性表面波フィルタSAWg, SAWdと整合素子13G, 13Dとの距離を最小限に抑え、フィルタSAWg, SAWdと整合素子13G, 13Dとの間の損失を抑えて高周波特性を改善することができる。

【0053】

また、整合素子13G, 13DのインダクタLg, Ldはセラミック積層基板においてLCフィルタ12G, 12Dのインダクタ及びコンデンサとは平面視で重ならないように形成されているため、送受信経路間でのアイソレーションを確保し、信号の混入を防止することができる。同様の効果は、整合素子13G, 13DのインダクタLg, Ldはセラミック積層基板の表面に搭載されており、LCフィルタ12G, 12Dのインダクタ及びコンデンサはセラミック積層基板の内部に内蔵されていることによっても達成される。

【0054】

さらに、本実施例においては、整合素子13G, 13DのコンデンサC1g, C2g, C1d, C2dとLCフィルタ12G, 12Dのインダクタ及びコンデンサとは平面視で重ならないように形成されている。これにて、送受信経路間での信号の混入を、さらに効果的に防止することができる。

【0055】

また、整合素子13G, 13DのインダクタLg, LdとLCフィルタ12G, 12Dのインダクタ及びコンデンサとの間にはグラウンド電極G4が配置されているため、両者の干渉を効果的に防止することができる。同様の効果は、LCフィルタ12G, 12Dのコンデンサ、特に、シャントコンデンサGcu1, Gcu2, DCu1, DCu2がセラミック積層基板の最下層近辺に形成されていることによっても達成される。整合素子13G, 13DのインダクタLg, Ld及びコンデンサC1g, C2g, C1d, C2dがセラミック積層基板の表面に形成されており、整合素子13G, 13DのインダクタLg, Ldは他の素子を介さずに整合素子13G, 13DのコンデンサC1g, C2g, C1d, C2dに隣接配置することも、同様に相互干渉を防止することができる。

【0056】

さらに、本実施例においては、整合素子13G, 13DのコンデンサC1g, C2g, C1d, C2dとLCフィルタ12G, 12Dのインダクタ及びコンデンサの間にもグラウンド電極G4が配置されている。これにより、両者の干渉をより効果的に防止することができる。

【0057】

(第3実施例、図9及び図10参照)

本第3実施例である高周波複合部品は、図9のブロック図にその特徴的な構成を示すように、前記第2実施例と同様に、GSM系及びDCS系を備えたデュアルバンド対応型の高周波複合部品であり、バランス型弾性表面波フィルタSAWg, SAWdの平衡出力部にそれぞれコンデンサC1g, C2g及びC1d, C2dが直列に接続されているとともに、受信側バランス出力端子Rxg, RxdにインダクタLg, Ldが並列に接続されている。

【0058】

このように、コンデンサC1g, C2g及びコンデンサC1d, C2dをそれぞれ第1

・第2弾は共振回路ノードの出力を、共振回路の出力に直列に接続し、インダクタと、コイルを第1・第2受信側バランス出力端子Rxg, Rxd側にそれぞれ並列に接続することにより、第1・第2受信側バランス出力端子Rxg, Rxdのインピーダンスを自由に設定でき、特にインピーダンスを上げることができる。

【0059】

なお、本第3実施例において、第1・第2整合素子13G, 13D以外の回路構成及び動作は前記第2実施例と同様であり、重複する説明は省略する。

【0060】

(第4実施例、図11～図15参照)

本第4実施例である高周波複合部品は、図11の等価回路図に示すように、GSM系及び二つの受信側バランス出力端子Rxd1, Rxd2に分岐されたDCS系とを備えたトリプルバンド対応型の高周波複合部品として構成されている。

【0061】

即ち、GSM系は第1高周波スイッチ11Gと第1LCフィルタ12Gとバランス型第1弾性表面波フィルタSAWgと第1整合素子13Gとを備えている。このGSM系の構成及び作用は前記第2・第3実施例と同様であり、重複した説明は省略する。

【0062】

デュプレクサ20に関しても前記第2・第3実施例と基本的には同様の構成を備え、さらに、第1ポートP11とアンテナ端子ANTとの間にコンデンサCantが接続されるとともに、その接続点はインダクタLantを介して接地される。

【0063】

DCS系は、第2高周波スイッチ11D'と第2LCフィルタ12Dと第2送信側入力端子Tx dとで構成されている。この部分の回路構成は前記第2・第3実施例と同様であり、重複した説明は省略する。

【0064】

DCS系において、第2高周波スイッチ11D'の第3ポートP33dはデュプレクサ14Dが接続されており、このデュプレクサ14Dは、受信信号経路を第2受信側バランス出力端子Rxd1と第3受信側バランス出力端子Rxd2とに分岐するためのものである。

【0065】

第2高周波スイッチ11D'は、アンテナ端子ANTと第2送信側入力端子Tx dとの間の信号経路と、アンテナ端子ANTと第2・第3受信側バランス出力端子Rxd1, Rxd2との間の信号経路とを選択的に切り換える。

【0066】

第2高周波スイッチ11D'は、スイッチング素子であるダイオードDD1, DD2、インダクタDP SL1, D SL2, DP SLt、コンデンサDC5, DC6, DPCt及び抵抗DR1で構成されている。第1ポートP31dと第2ポートP32dとの間に、アノードが第2ポートP32d側になるようにダイオードDD1が接続され、このアノードはインダクタDP SL1及びコンデンサDC6を介して接地される。インダクタDP SL1とコンデンサDC6との接続点に制御端子Vc2が接続されている。また、第1ポートP31dと第2ポートP32dとの間には、コンデンサDPCtとインダクタDP SLtの直列回路がダイオードDD1とは並列に接続されている。ダイオードDD2はアノードがインダクタD SL2を介して第1ポートP31dに接続され、カソードがコンデンサDC5を介して接地される。ダイオードDD2とコンデンサDC5との接続点は抵抗DR1を介して接地される。

【0067】

デュプレクサ14Dは、第1ポートP41dと第2ポートP42dとの間にインダクタPSL2が接続され、インダクタPSL2と第2ポートP42dとの接続点はコンデンサPC7を介して接地される。第2ポートP42dは第2弾性表面波フィルタSAWd1に接続されている。また、デュプレクサ14Dの第1ポートP41dと第3ポートP43d

この間にコンデンサC_jが接続されている。コンデンサC_jと第1ポートP_{43d}との接続点はコンデンサC_jを介して接地されるとともに、コンデンサD_{C7}と第3ポートP_{43d}との接続点はインダクタD_{SL1}を介して接地される。第3ポートP_{43d}は第3弾性表面波フィルタS_{AWd2}に接続されている。

【0068】

第2弾性表面波フィルタS_{AWd1}の平衡出力部には第2整合素子13D₁が接続され、第3弾性表面波フィルタS_{AWd2}の平衡出力部には第3整合素子13D₂が接続されている。この第2・第3整合素子13D₁、13D₂は第2実施例と同様に、インダクタL_dを弾性表面波フィルタS_{AWd1}、S_{AWd2}側に並列に接続し、コンデンサC_{1d}、C_{2d}をインダクタL_dと受信側バランス出力端子R_{x d1}、R_{x d2}との間にそれぞれ直列に接続したものである。その作用効果は第2実施例と同様である。なお、第2・第3整合素子13D₁、13D₂は前記第3実施例と同じ回路構成としてもよく、この場合には第3実施例と同様の作用効果を奏する。

【0069】

図12～図14は、本第4実施例である高周波複合部品のセラミック多層基板を構成する各シート層上にスクリーン印刷などで形成されたコンデンサ電極、ストリップライン電極などを示している。

【0070】

第1シート層62aには種々の外部接続用端子電極が形成されている。第2シート層62bにはグランド電極G₁₁が形成され、第3シート層62cにはコンデンサC_{u1}、C_{t2}、D_{C6}の電極が形成され、グランド電極G₁₁とでキャパシタンスを形成している。第4シート層62dにはグランド電極G₁₂が形成され、第5シート層62eにはコンデンサD_{Cu1}、D_{Cu2}、C_j、G_{Cu1}、G_{Cu2}の電極が形成され、グランド電極G₁₂とでキャパシタンスを形成している。

【0071】

第8シート層62hにはストリップライン電極によってインダクタL_{t1}、L_{t2}、D_{Lt1}、D_{Lt2}、G_{Lt1}、G_{SL2}、D_{SL2}、P_{SL2}が形成されている。第9シート層62iにはストリップライン電極によってインダクタG_{SL2}、L_{t1}が形成され、それぞれがビアホールにて下層の電極と接続されている。

【0072】

第10シート層62jにはストリップライン電極によってインダクタL_{t1}、L_{t2}、D_{Lt1}、D_{Lt2}、G_{Lt1}、G_{SL2}、D_{SL2}、P_{SL2}が形成され、下層の同種の電極とビアホールを介して接続されている。第11シート層62kにはストリップライン電極によってインダクタL_{t1}、G_{SL2}が形成され、それぞれがビアホールにて下層の同種の電極と接続されている。

【0073】

第12シート層62lにはストリップライン電極によってインダクタL_{t2}、D_{Lt1}、D_{Lt2}、G_{Lt1}、G_{SL2}、D_{SL2}が形成され、それぞれがビアホールにて下層の同種の電極と接続されている。第13シート層62mにはコンデンサC_{t1}、D_{Cc2}の電極が形成され、第14シート層62nにはコンデンサC_{t1}、C_{c1}の電極及びグランド電極G₁₃が形成されている。第15シート層62oにはコンデンサD_{C5}、C_{t1}、C_{c1}、G_{Cc1}、G_{C5}、D_{Cu1}、D_{Cc2}の電極が形成されている。第16シート層62pにはコンデンサC_{c2}、C_{Cc1}の電極及びグランド電極G₁₄が形成されている。第17シート層62qにはコンデンサD_{Cc1}の電極が形成されている。

【0074】

第19シート層62sの表面は、図15にも示すように、セラミック多層基板50の表面であって、種々の接続用端子電極が形成され、第1・第2・第3弾性表面波フィルタS_{AWg}、S_{AWd1}、S_{AWd2}、ダイオードG_{D1}、G_{D2}、D_{D1}、D_{D2}が搭載されている。さらに、第1整合素子13Gを構成するインダクタL_g、コンデンサC_{1g}、C_{2g}、第2・第3整合素子13D₁、13D₂を構成するインダクタL_d、コンデンサ

し 1 u, し 2 u が搭載されている。

【0075】

さらに、セラミック多層基板 50 の表面には、抵抗 R G, D R 1 が搭載され、インダクタ L a n t, D P C t, D P S L t, D S L 1, D P S L 1 が搭載され、コンデンサ C a n t, D C 7, P C 7 が搭載されている。

【0076】

本第 4 実施例である高周波複合部品においては、第 2 高周波スイッチ 1 1 D ' のダイオード D D 2 のオン、オフによって受信信号が第 2 受信側バランス出力端子 R x d 1 と第 3 受信側バランス出力端子 R x d 2 とに切り換えられる。その他の基本的な動作は前記第 2 実施例で説明したとおりであり、その作用効果も第 2 実施例と同様である。

【0077】

(他の実施例)

なお、本発明に係る高周波複合部品は前記実施例に限定するものではなく、その要旨の範囲内で種々に変更できることは勿論である。

【図面の簡単な説明】

【0078】

【図 1】 本発明に係る高周波複合部品の第 1 実施例の基本構成を示すブロック図である。

【図 2】 第 1 実施例の等価回路図である。

【図 3】 本発明に係る高周波複合部品の第 2 実施例の基本構成を示すブロック図である。

【図 4】 第 2 実施例の等価回路図である。

【図 5】 第 2 実施例のセラミック多層基板の各シート層（下から第 1 ～第 8 層）に形成した電極形状を示す説明図である。

【図 6】 第 2 実施例のセラミック多層基板の各シート層（下から第 9 ～第 15 層）に形成した電極形状を示す説明図である。

【図 7】 第 2 実施例のセラミック多層基板の各シート層（下から第 16 層及び第 17 層）に形成した電極形状を示す説明図である。

【図 8】 第 2 実施例のセラミック多層基板の表面における各回路素子の搭載状態を示す平面図である。

【図 9】 本発明に係る高周波複合部品の第 3 実施例の基本構成を示すブロック図である。

【図 10】 第 3 実施例の等価回路図である。

【図 11】 本発明に係る高周波複合部品の第 4 実施例の等価回路図である。

【図 12】 第 4 実施例のセラミック多層基板の各シート層（下から第 1 ～第 8 層）に形成した電極形状を示す説明図である。

【図 13】 第 4 実施例のセラミック多層基板の各シート層（下から第 9 ～第 15 層）に形成した電極形状を示す説明図である。

【図 14】 第 4 実施例のセラミック多層基板の各シート層（下から第 16 ～第 18 層）に形成した電極形状を示す説明図である。

【図 15】 第 4 実施例のセラミック多層基板の表面における各回路素子の搭載状態を示す平面図である。

【図 16】 従来のデュアルバンド携帯電話機のスイッチ回路を示すブロック図である。

【図 17】 従来のバンドパスフィルタの概略構成を示すブロック図である。

【符号の説明】

【0079】

1 1 … 高周波スイッチ

1 2 … L C フィルタ

1 3 … 整合素子

1 4 ... ノ ヲ ノ レ ノ ヲ

2 0 ... ダイブ レ ク サ

5 0 ... セ ラ ミ ッ ク 多 層 基 板

A N T ... ア ン テ ナ 端 子

T x ... 送 信 側 入 力 端 子

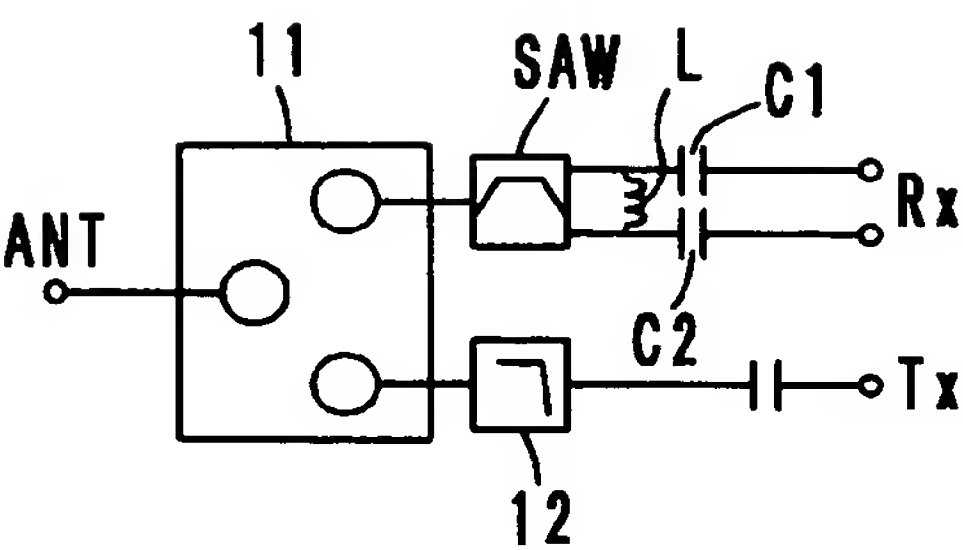
R x ... 受 信 側 バ ラ ン ス 出 力 端 子

S A W ... 弾 性 表 面 波 フ ィ ル タ

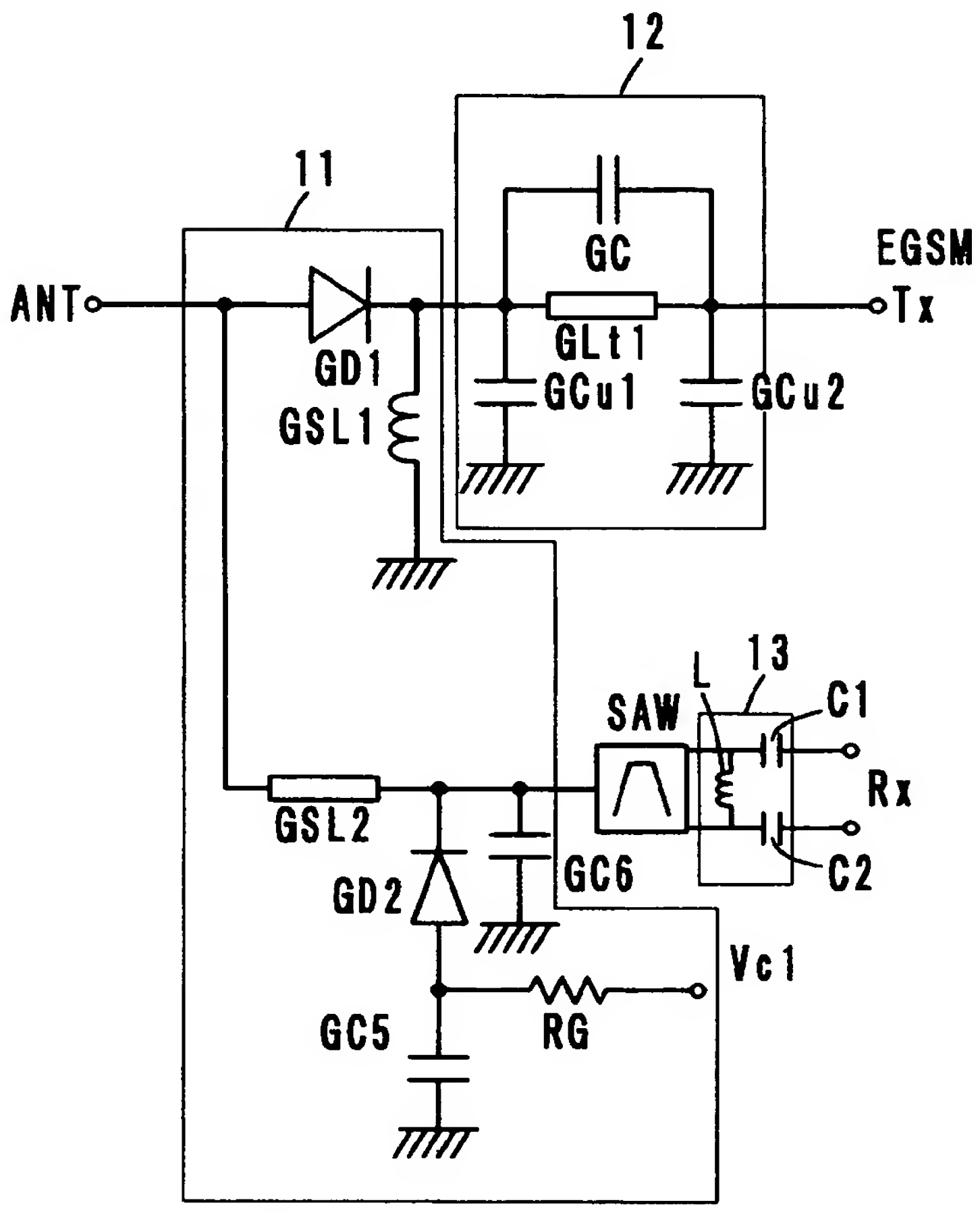
L , L g , L d ... イ ン ダ ク タ

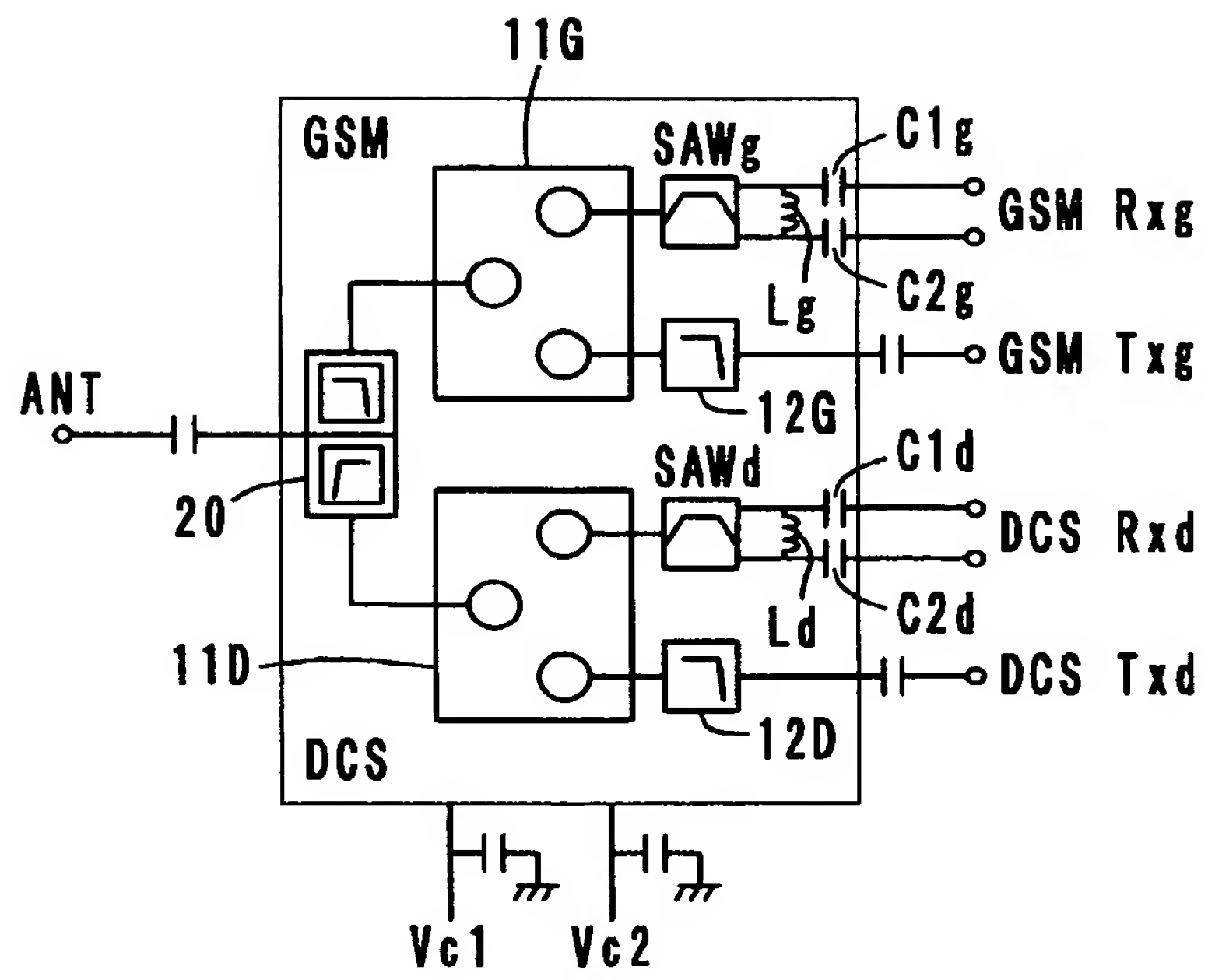
C 1 , C 2 , C 1 g , C 2 g , C 1 d , C 2 d ... コ ン デ ン サ

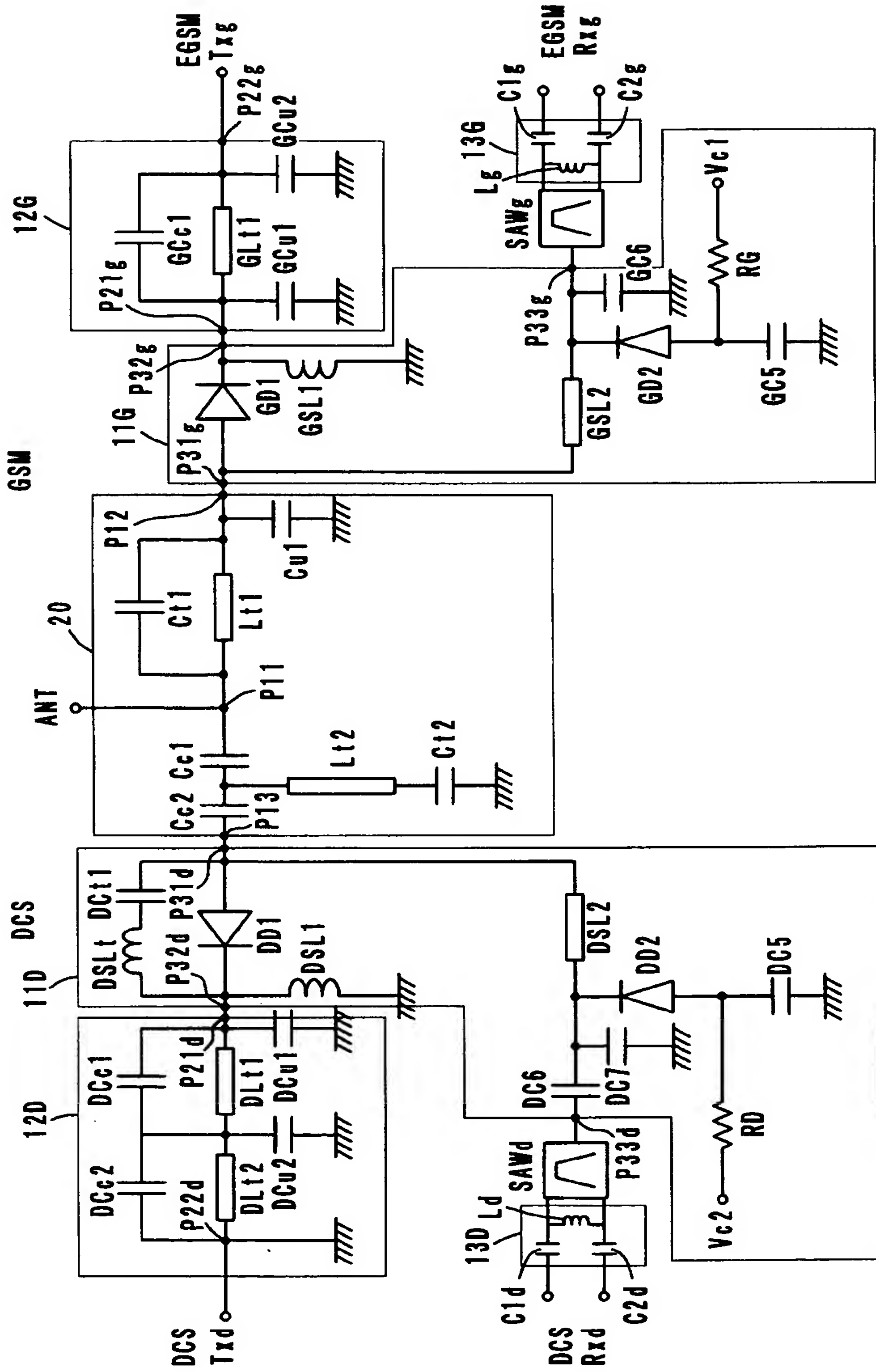
【图 1】

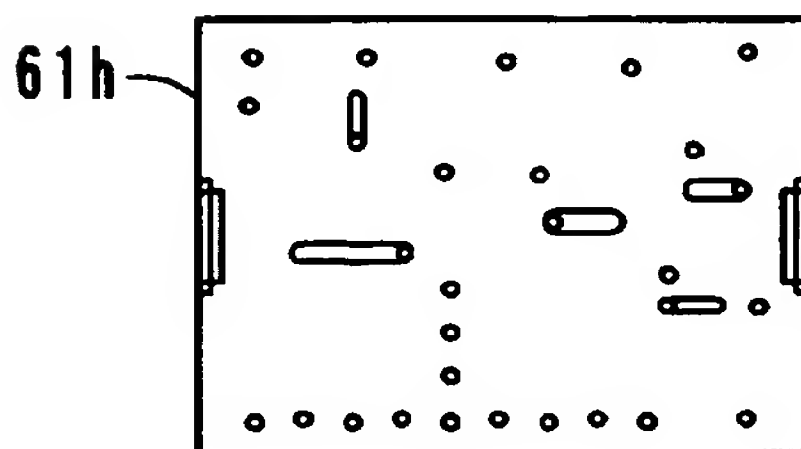
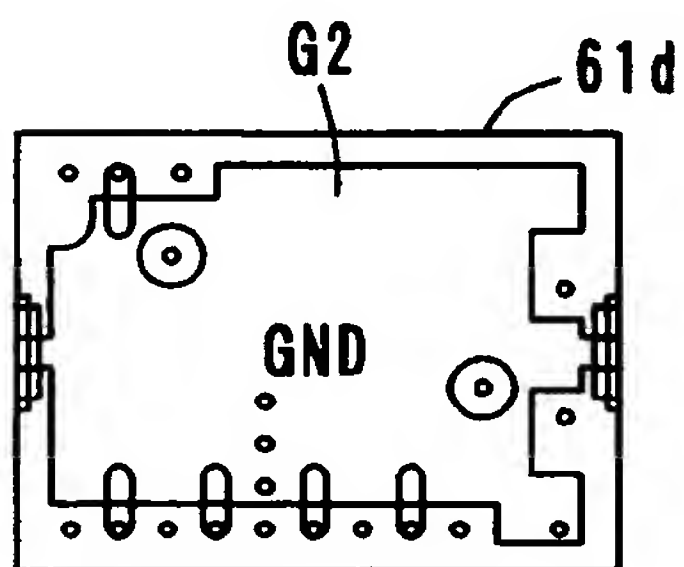
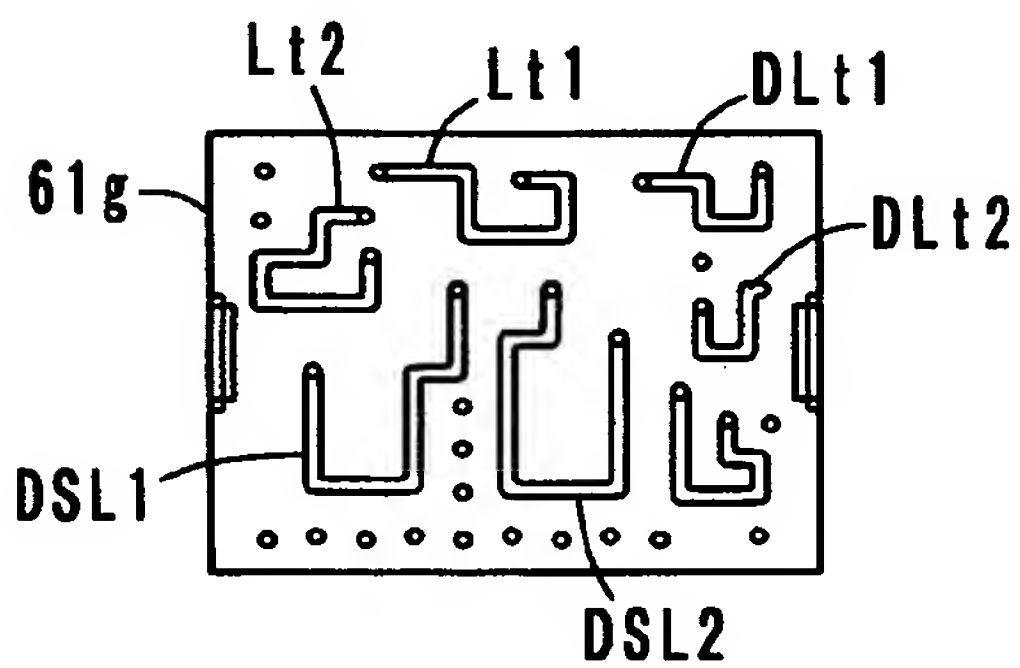
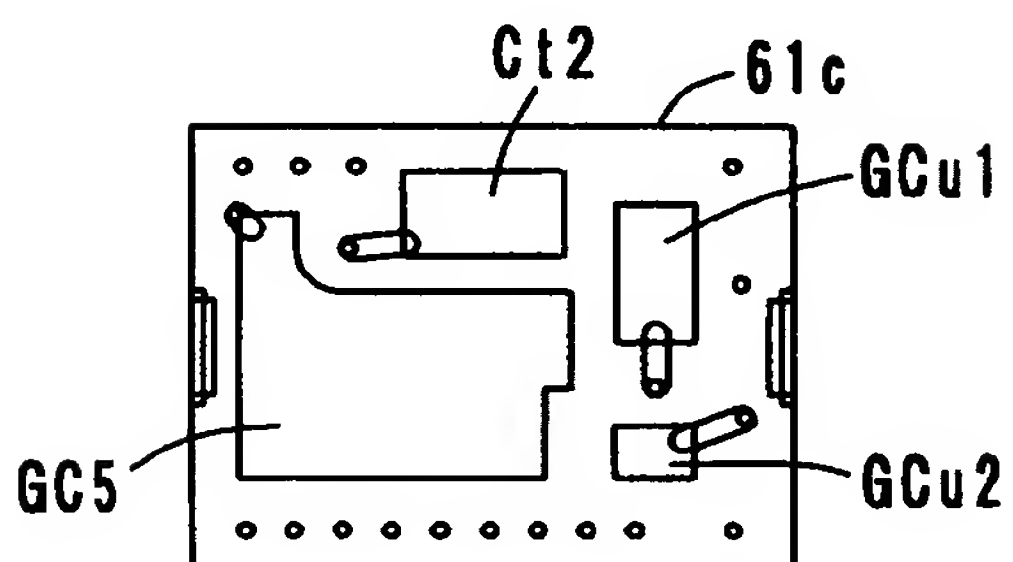
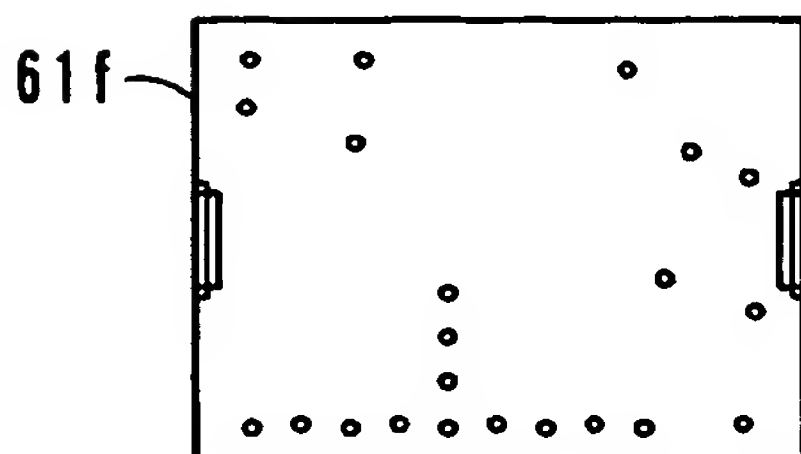
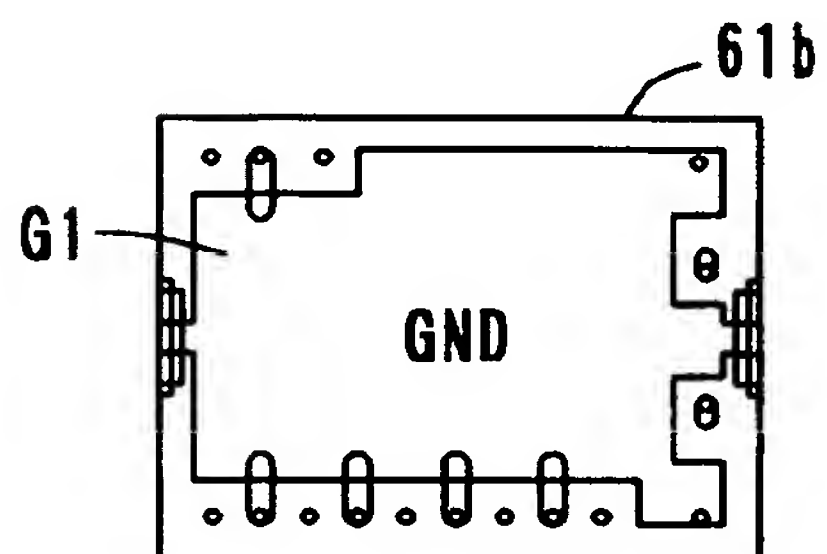
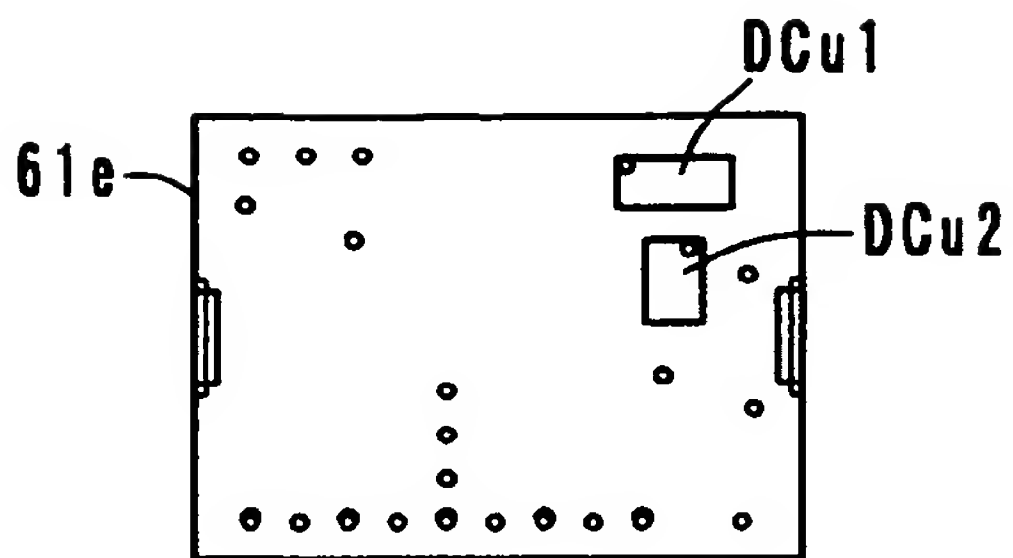
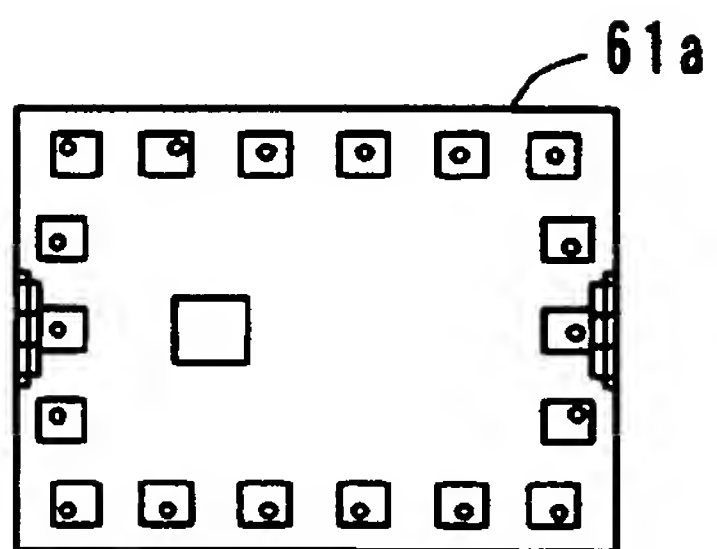


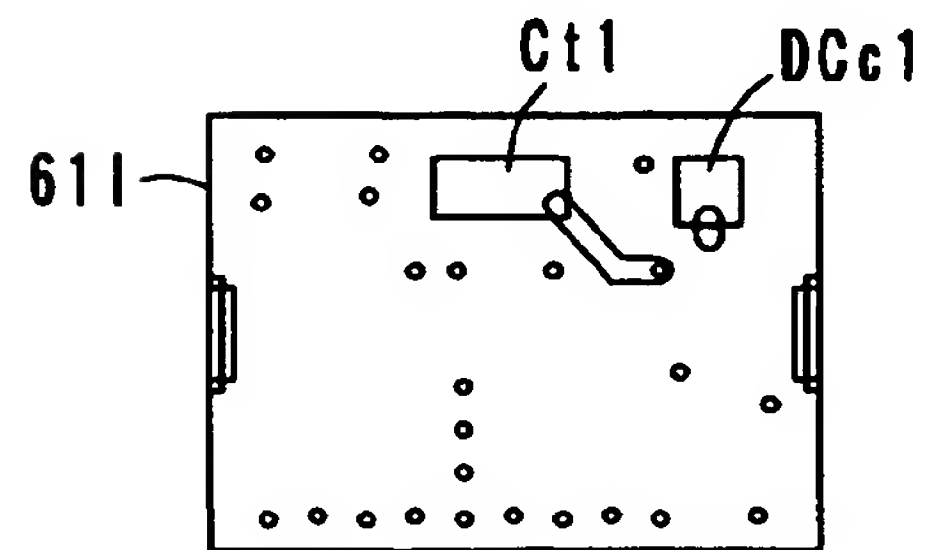
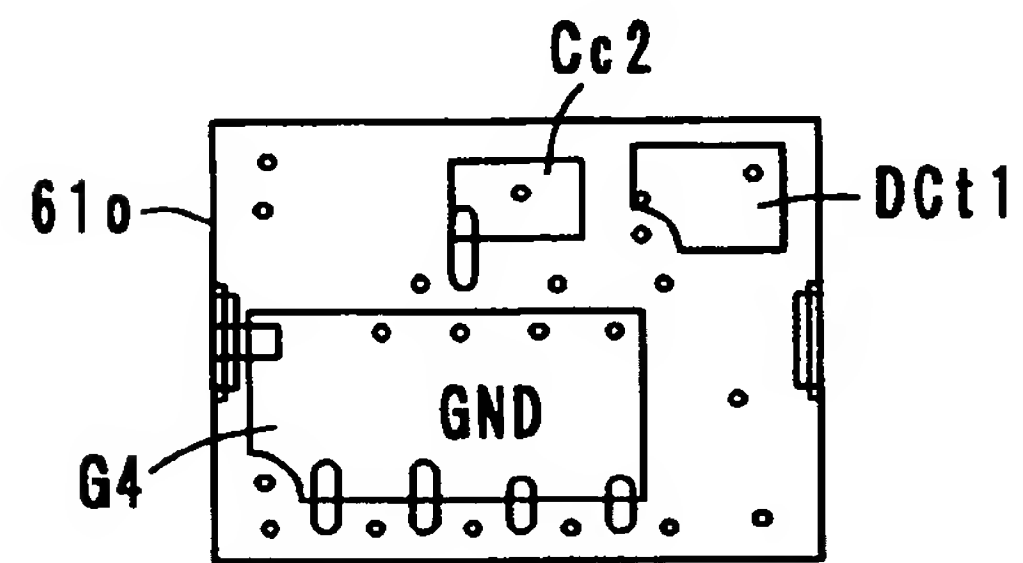
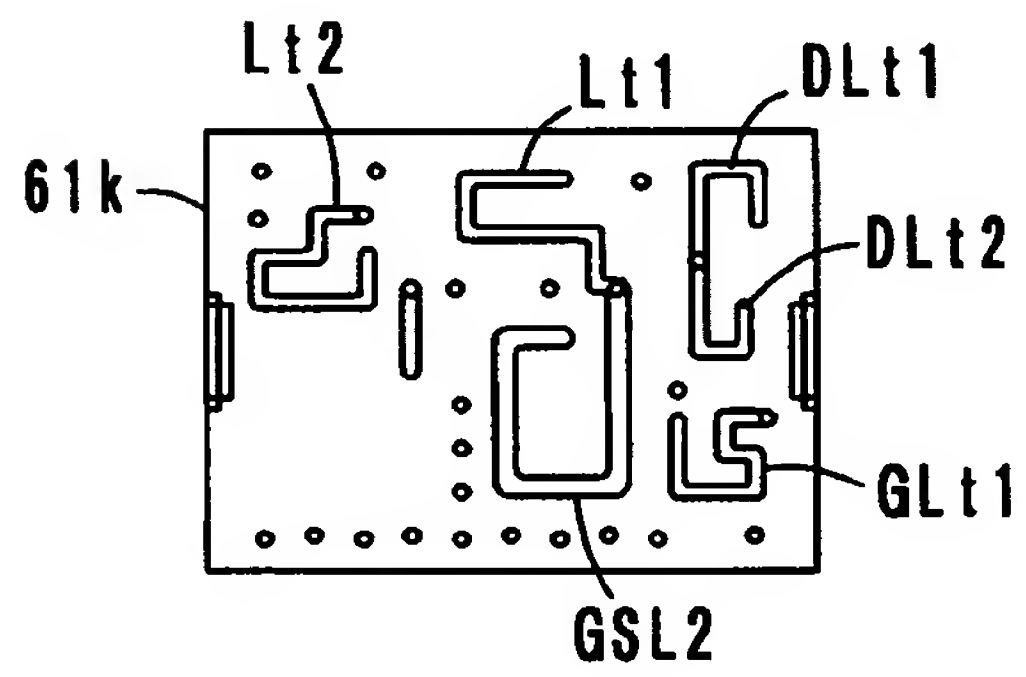
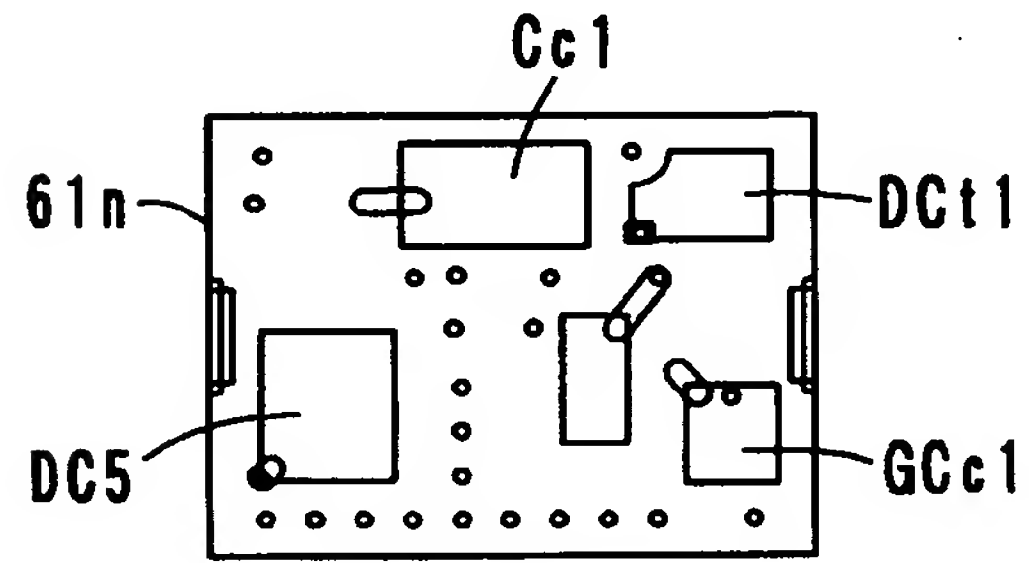
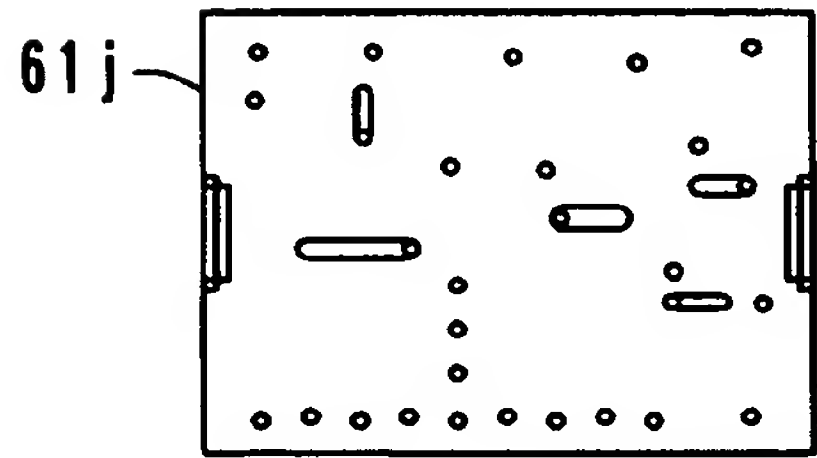
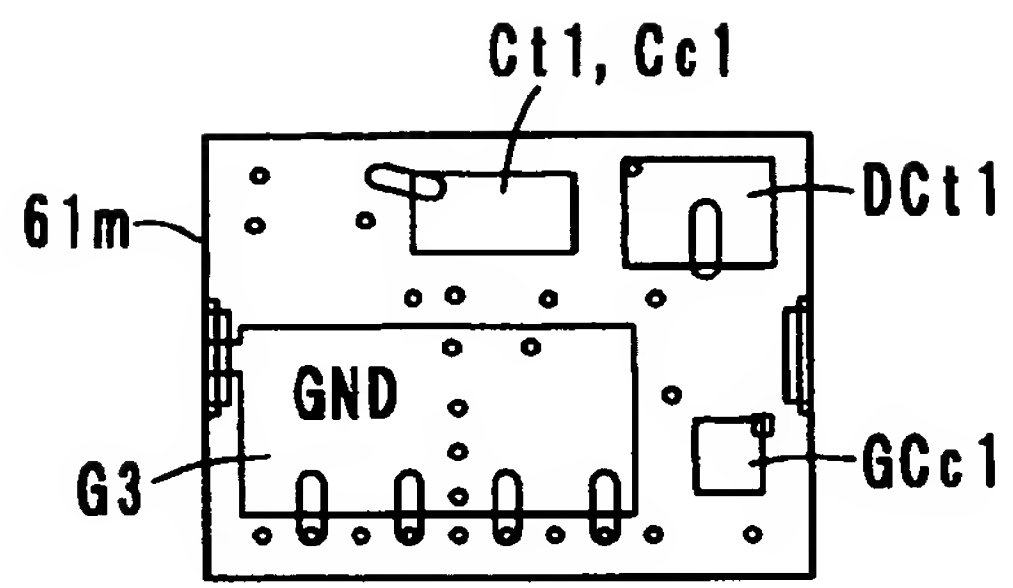
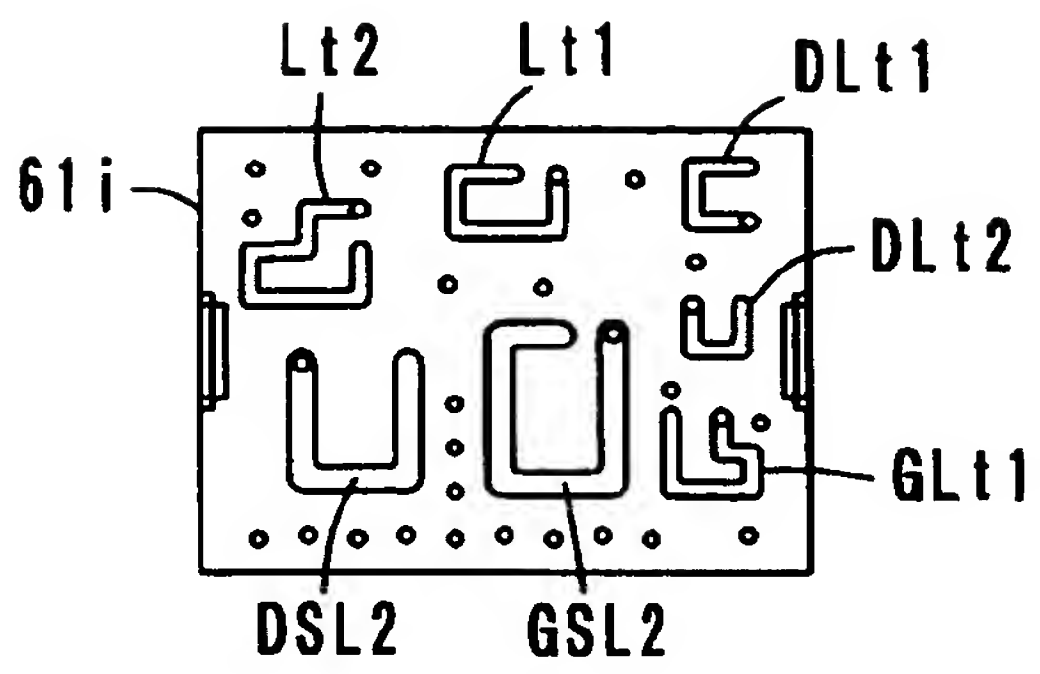
【图 2】

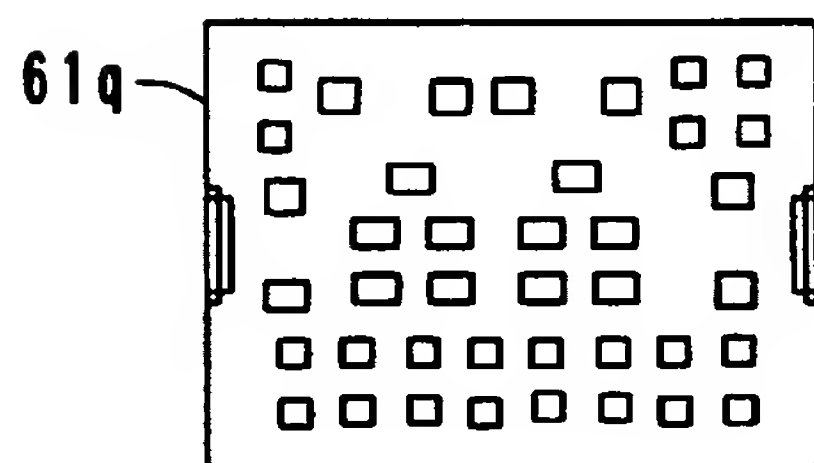
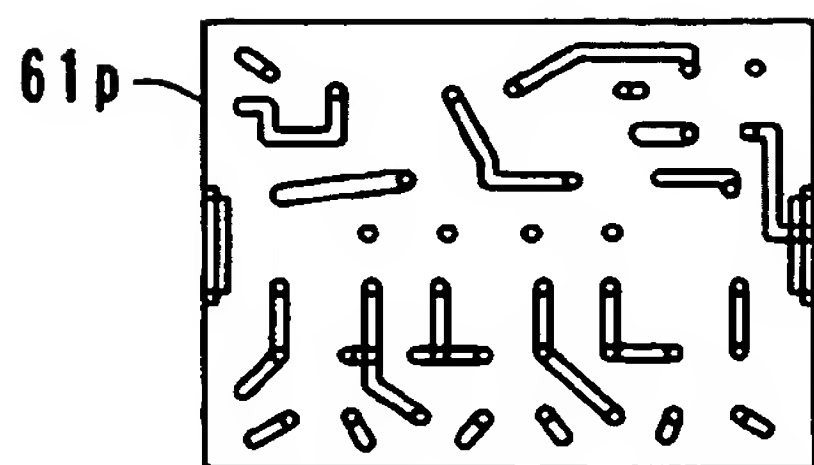




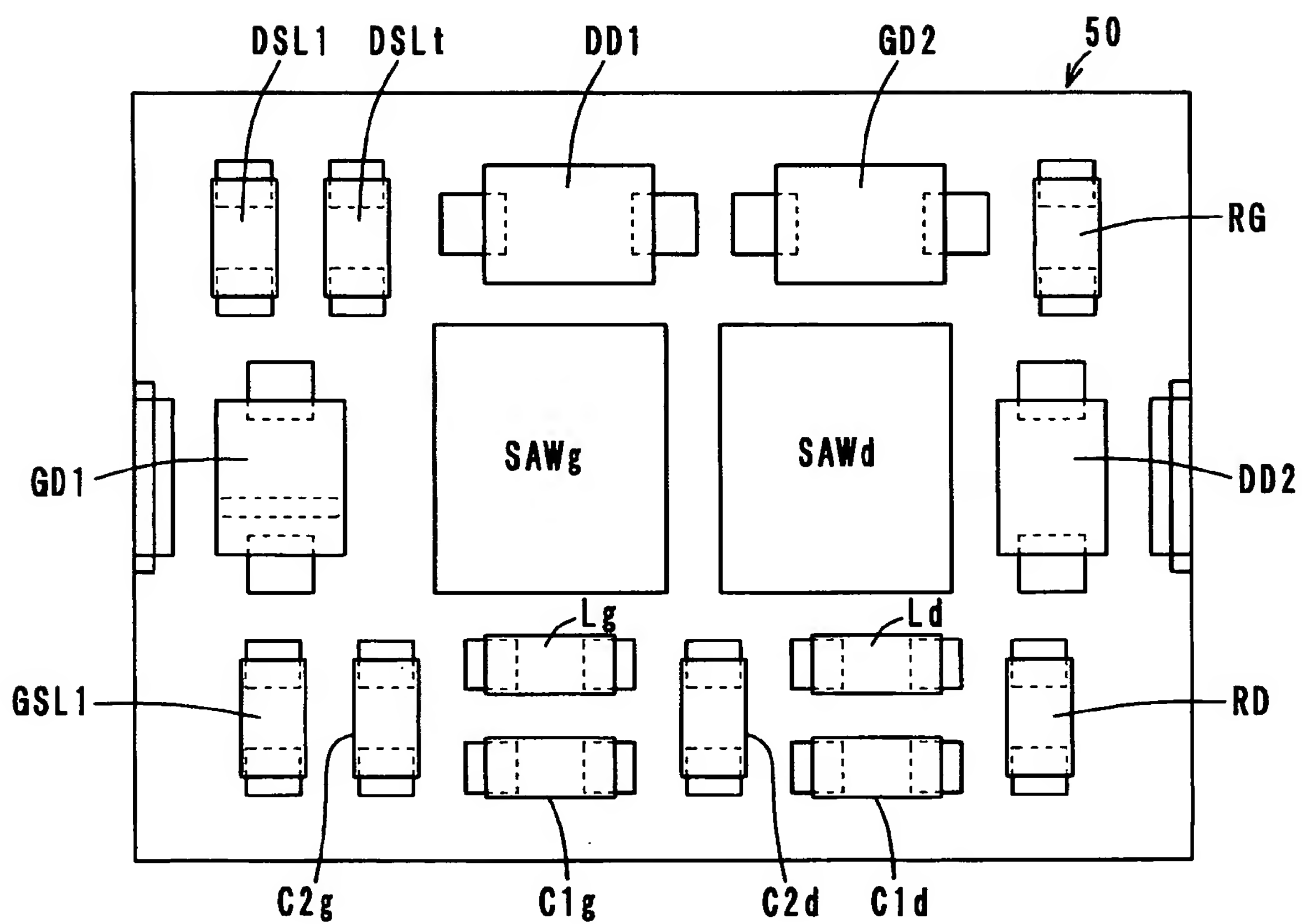


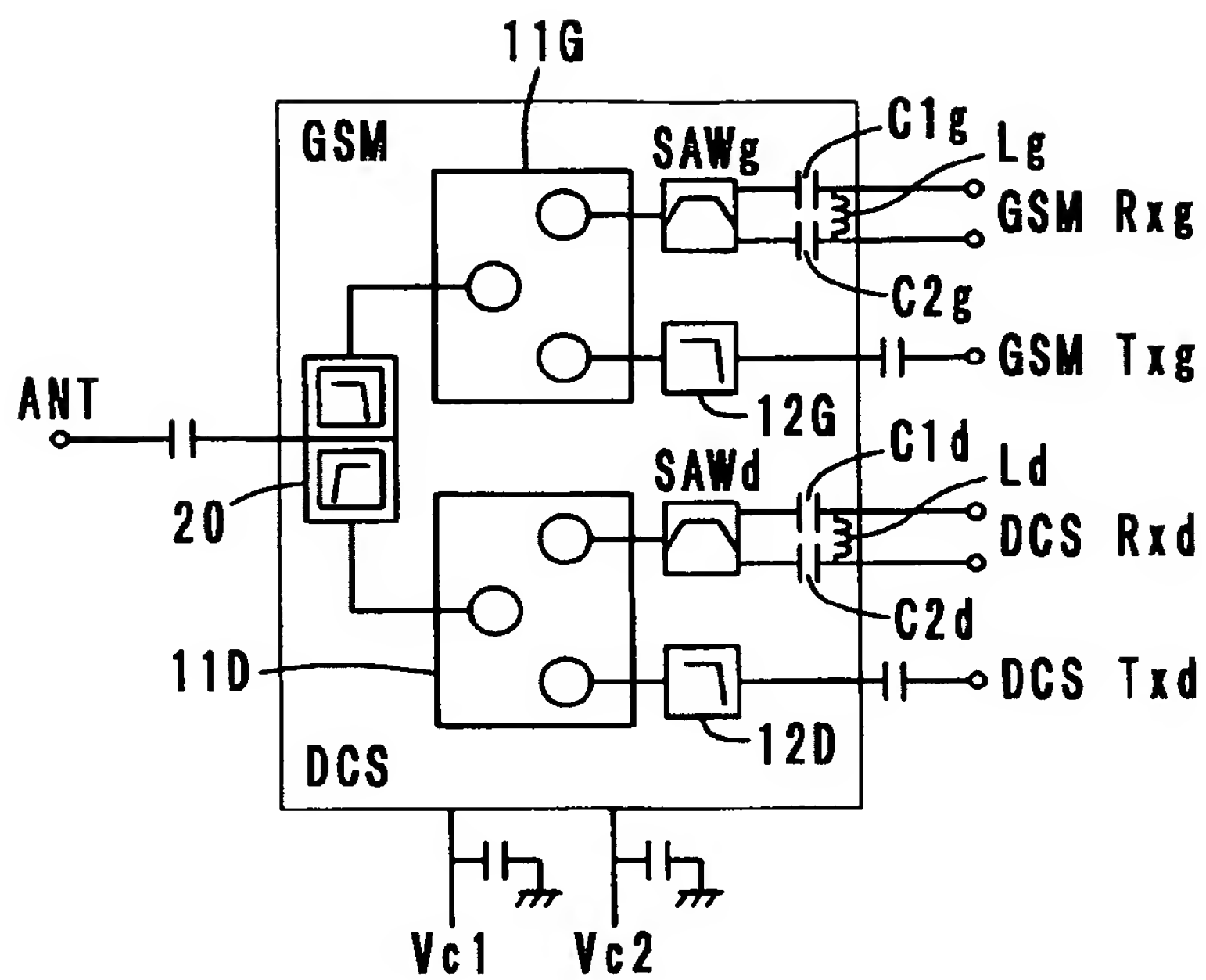


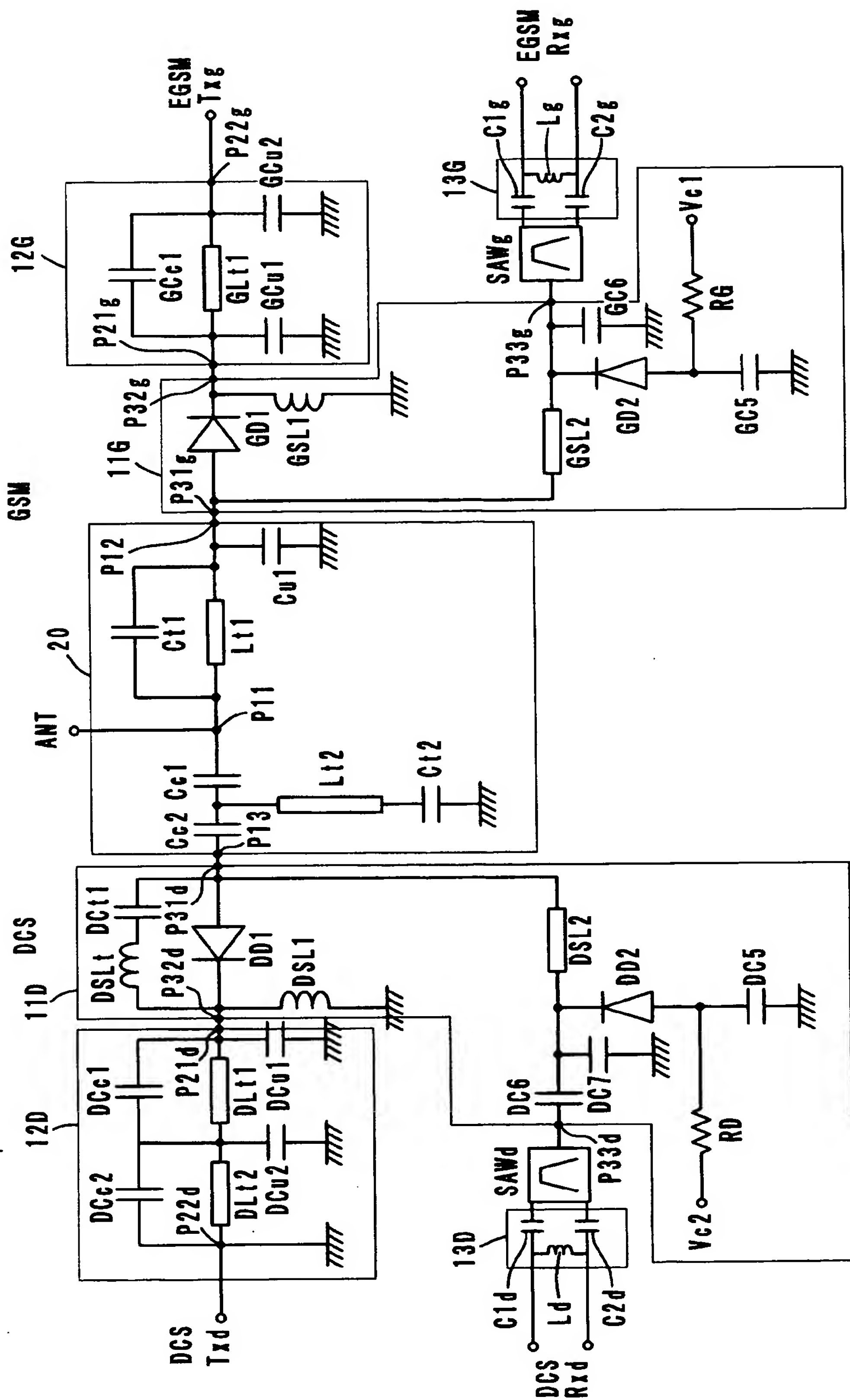


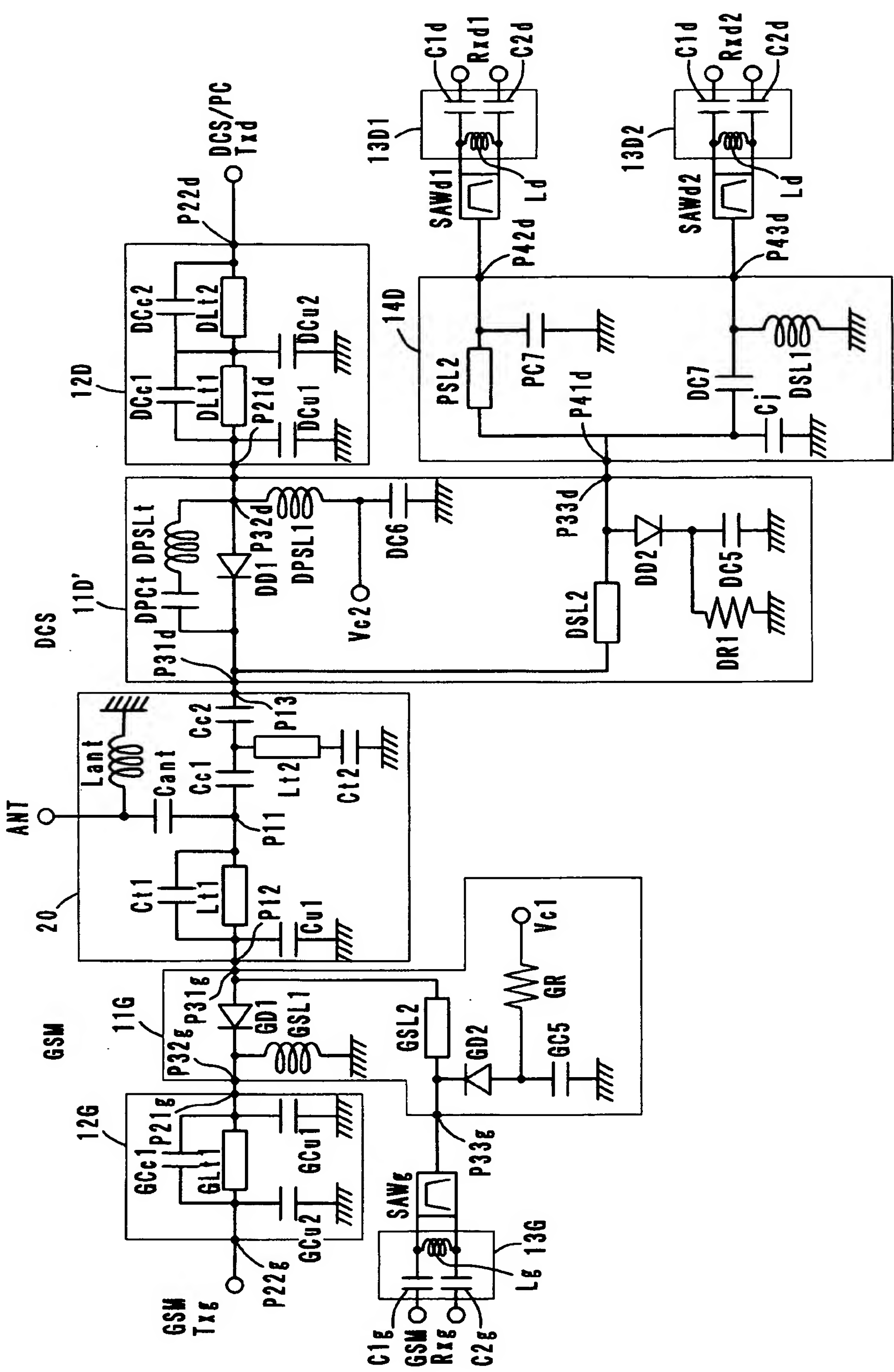


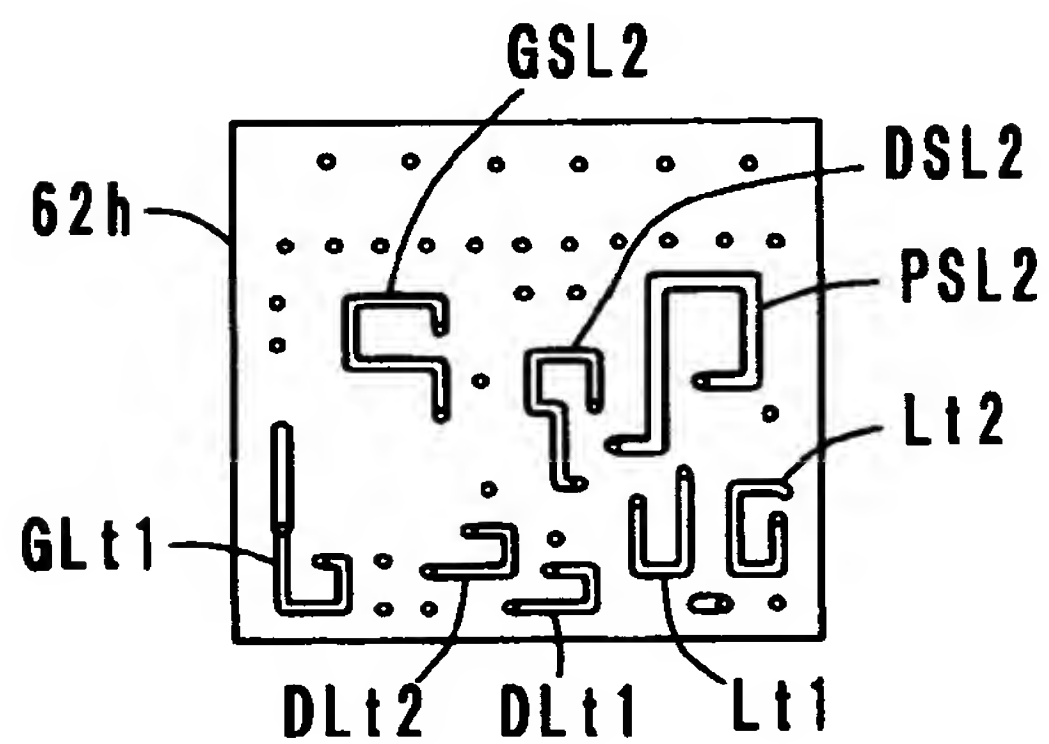
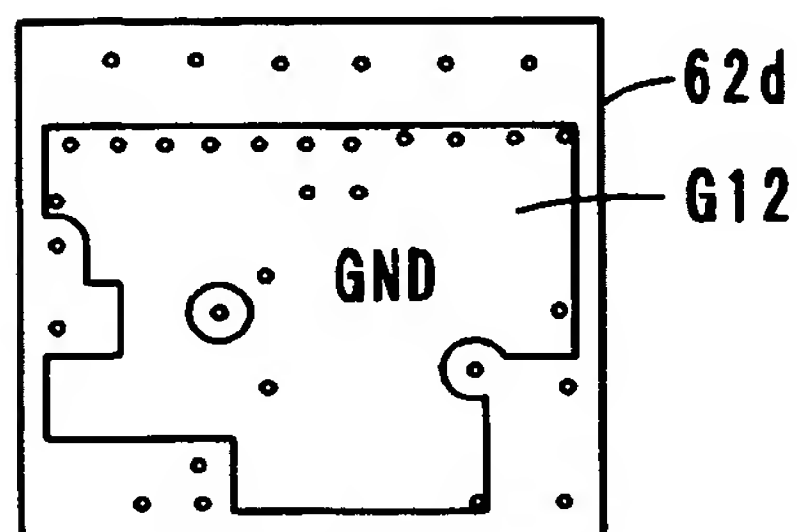
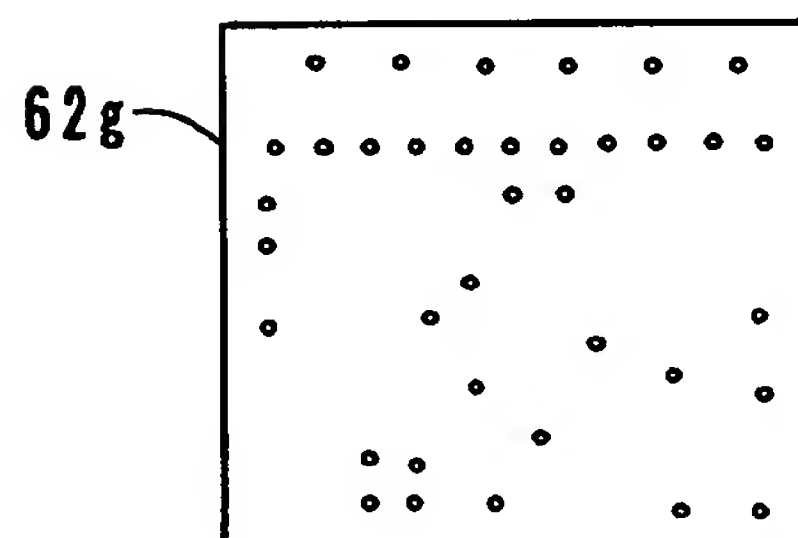
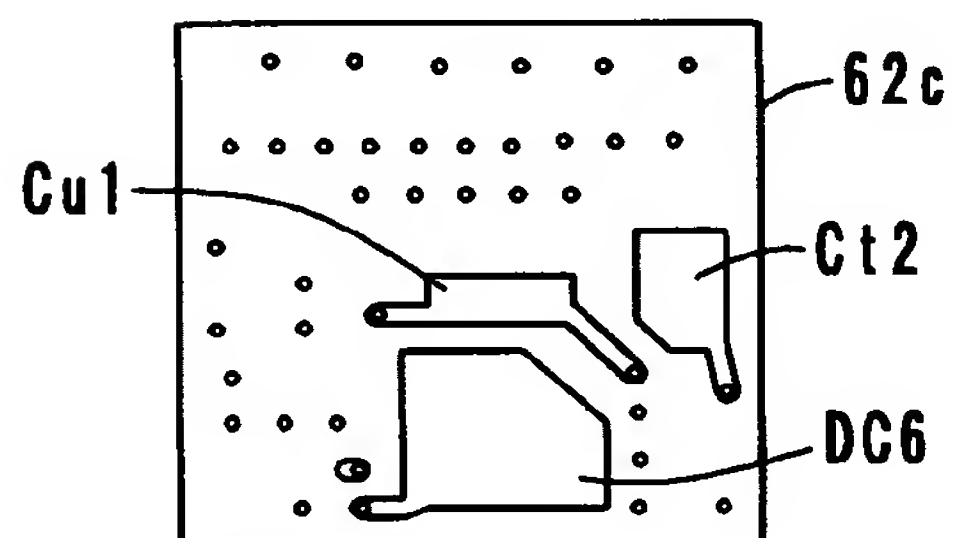
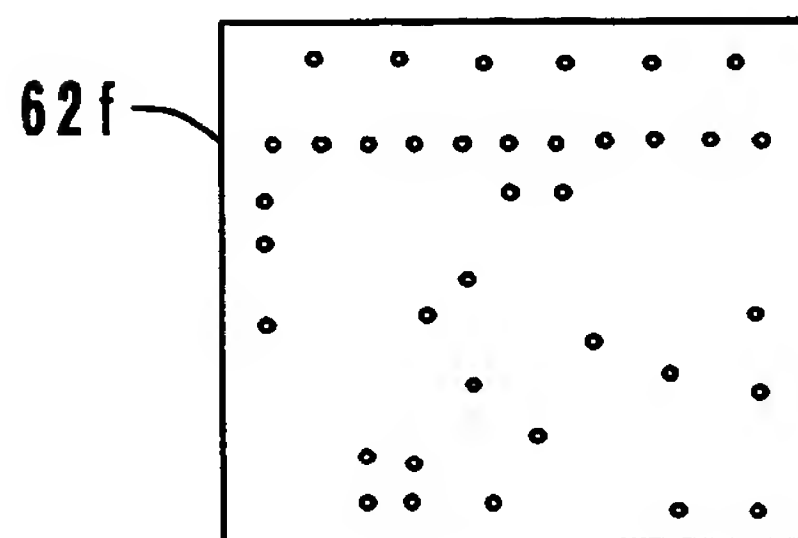
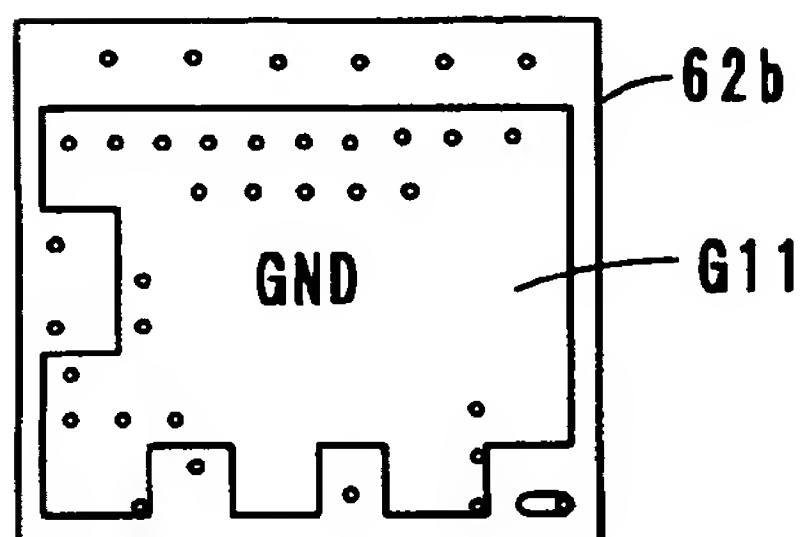
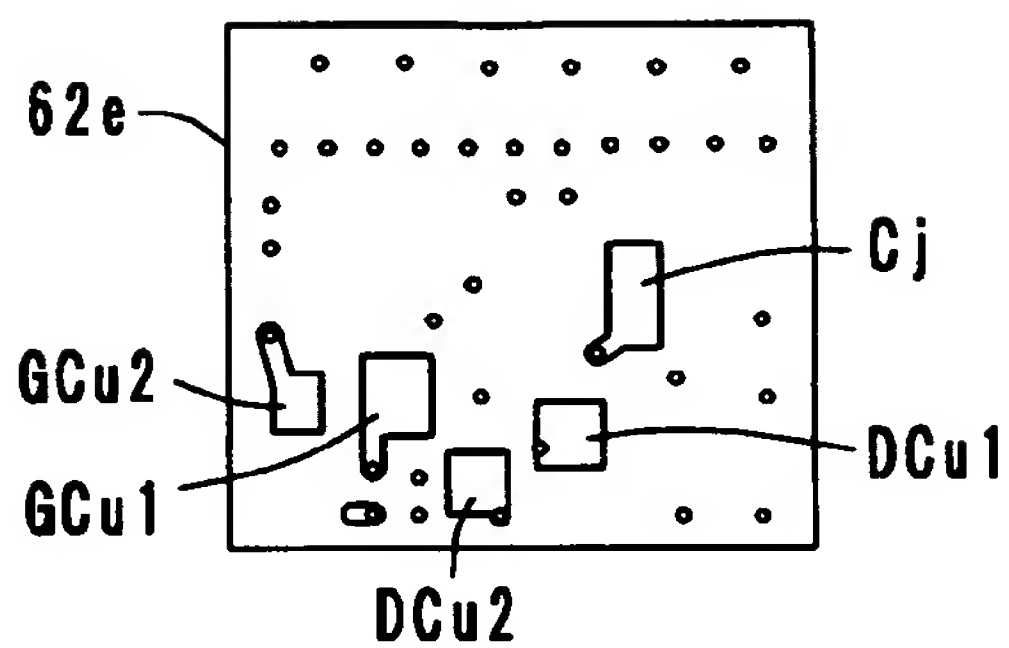
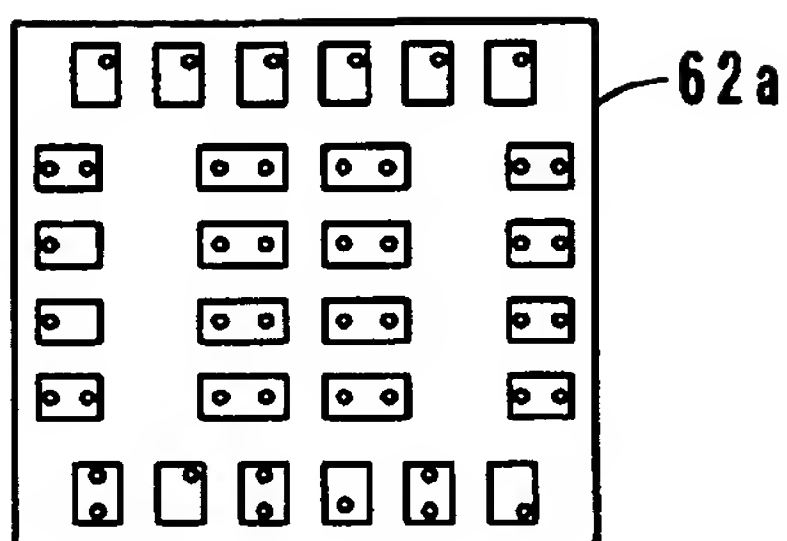
【図 8】

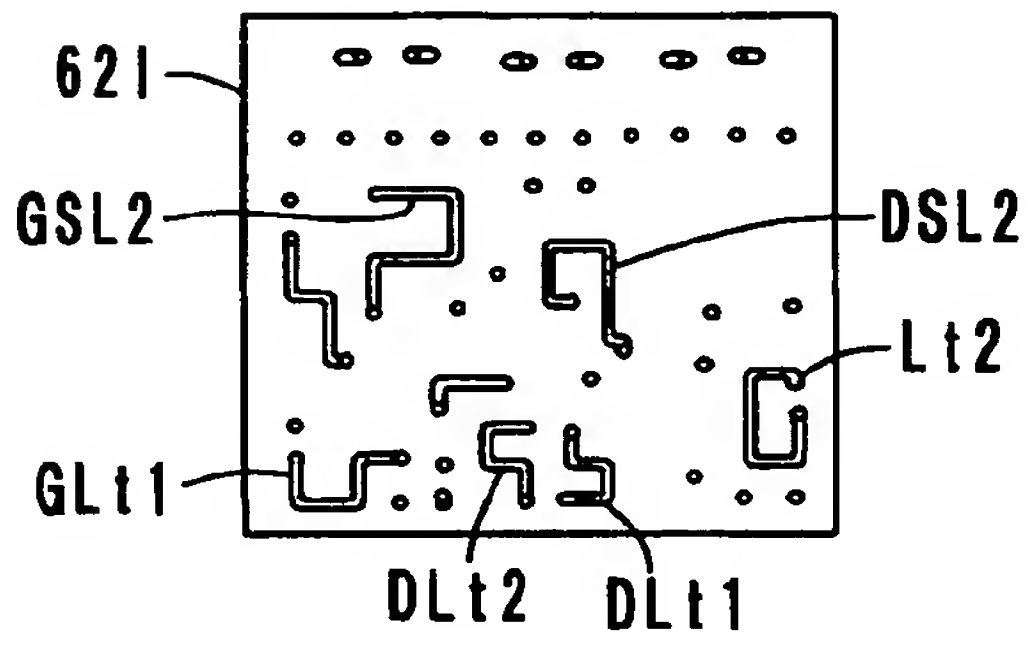
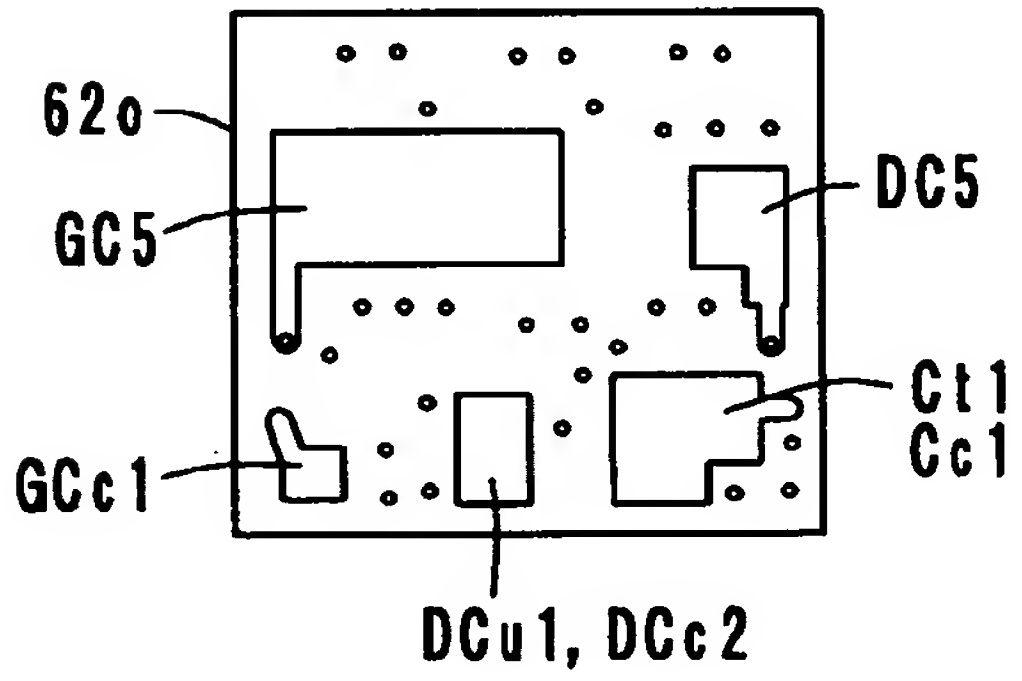
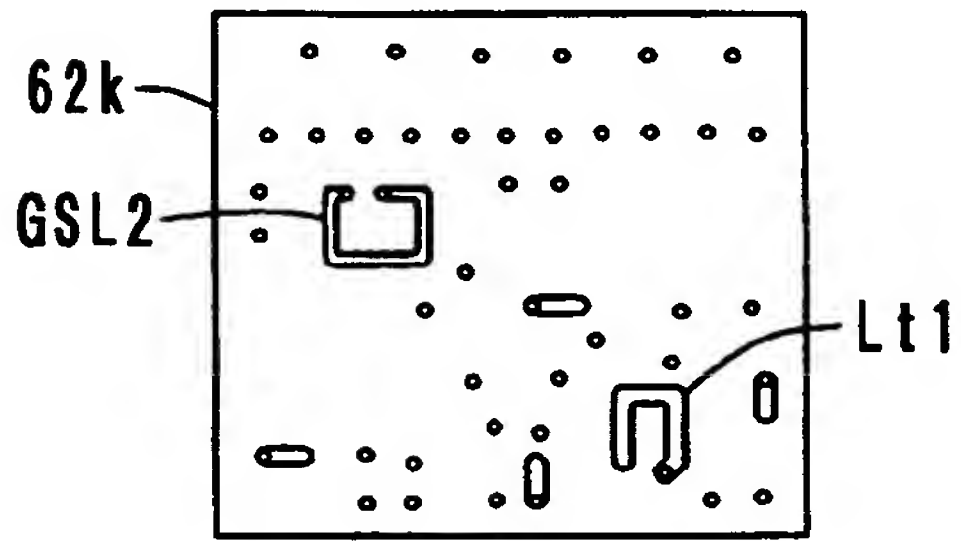
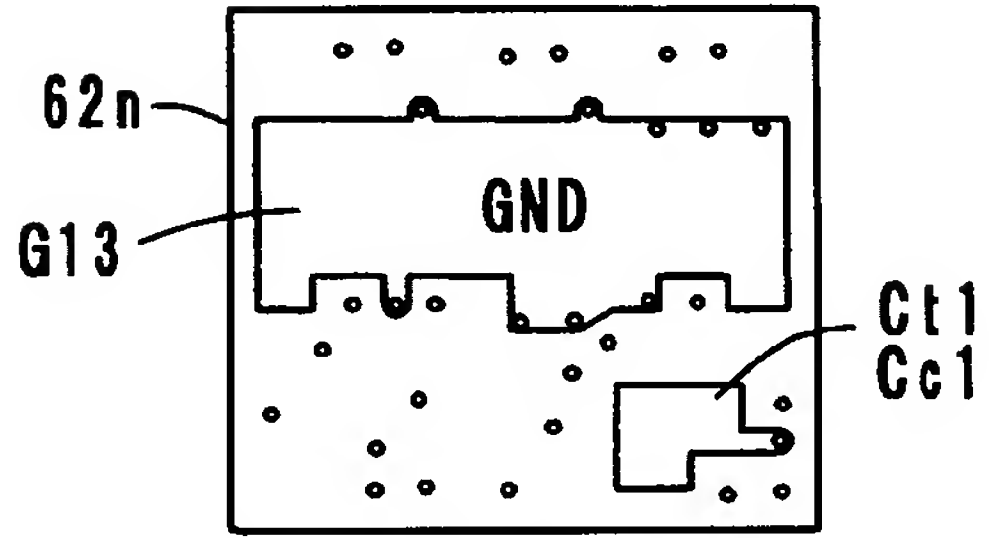
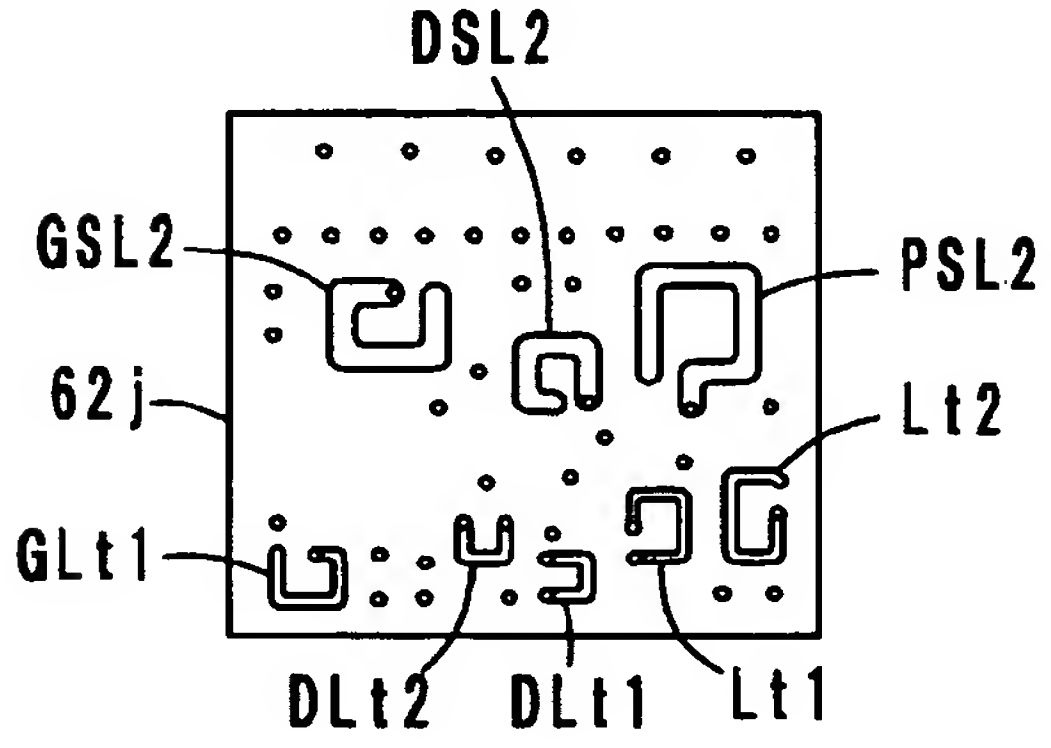
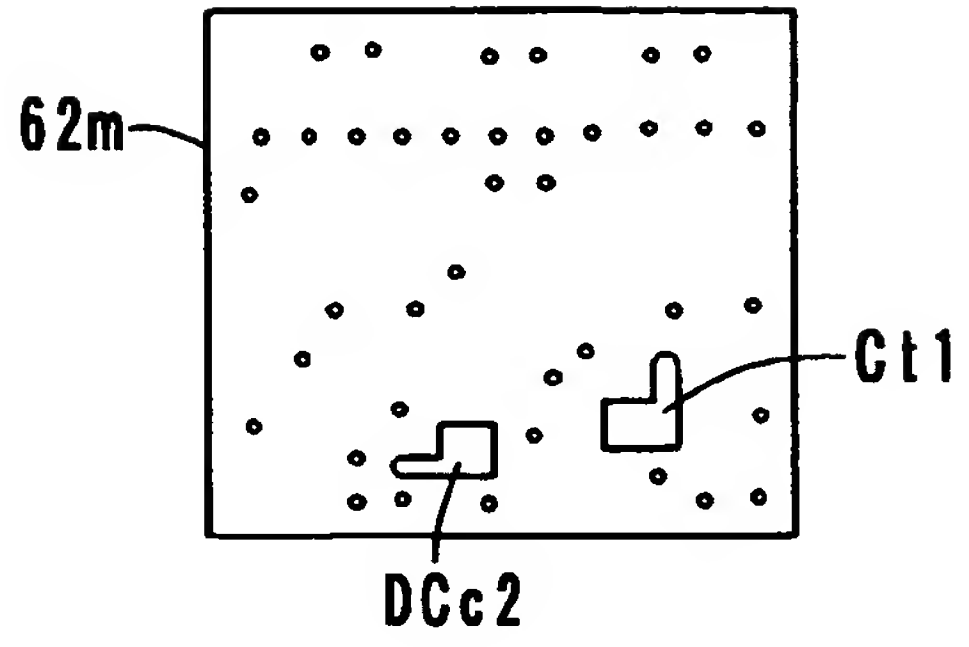
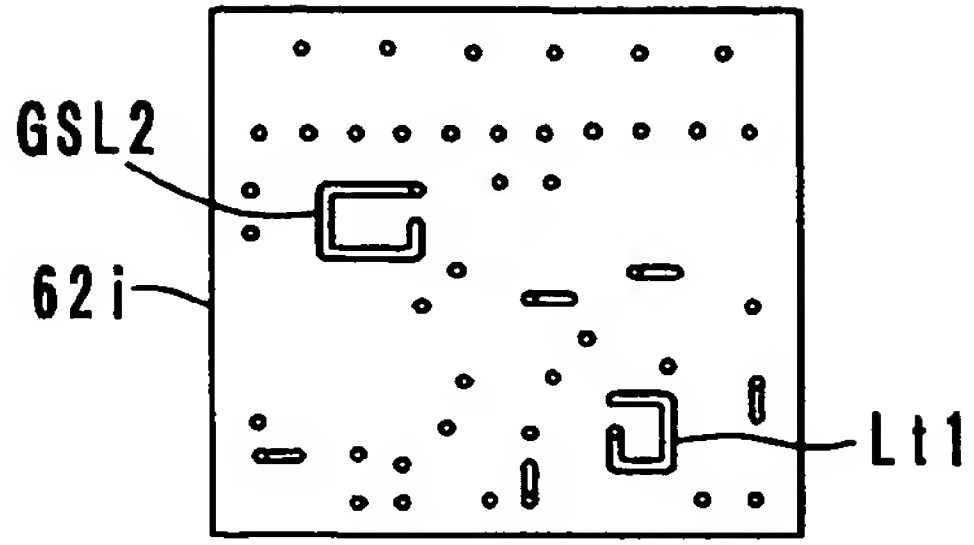


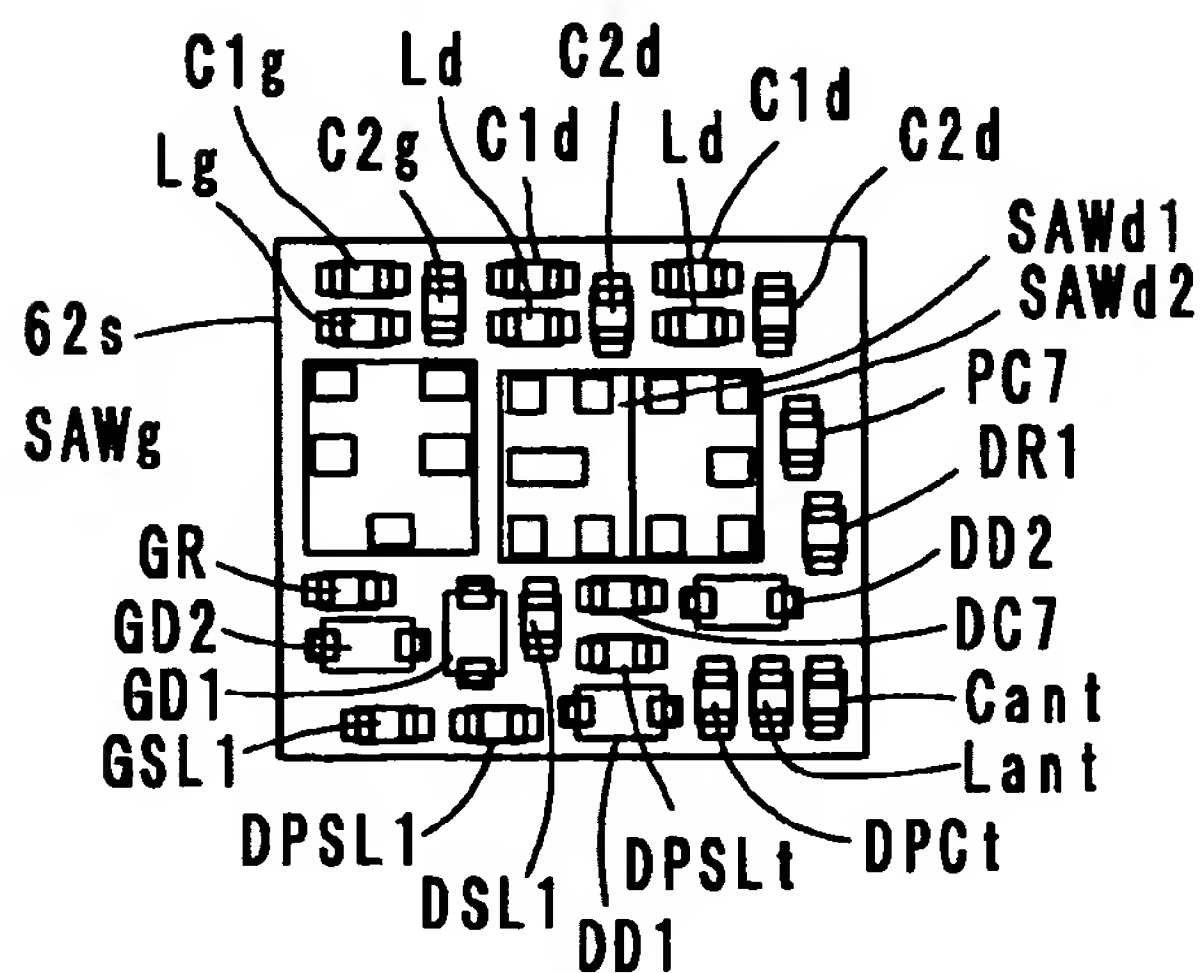
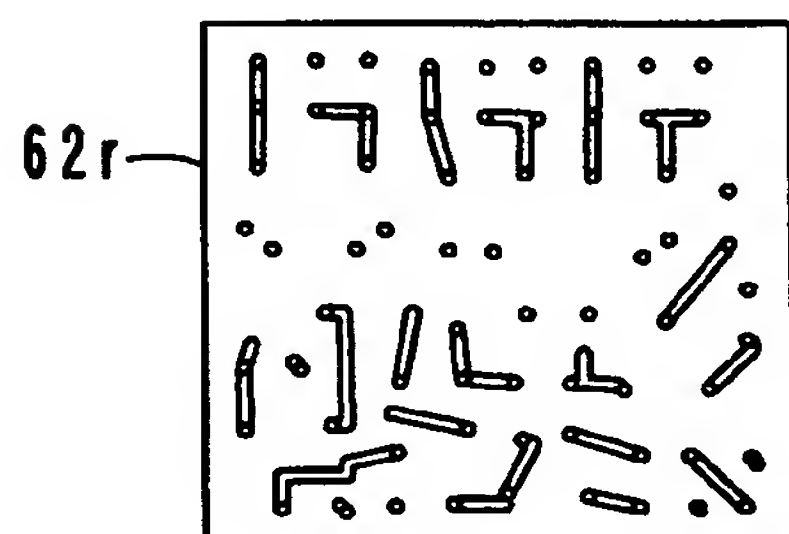
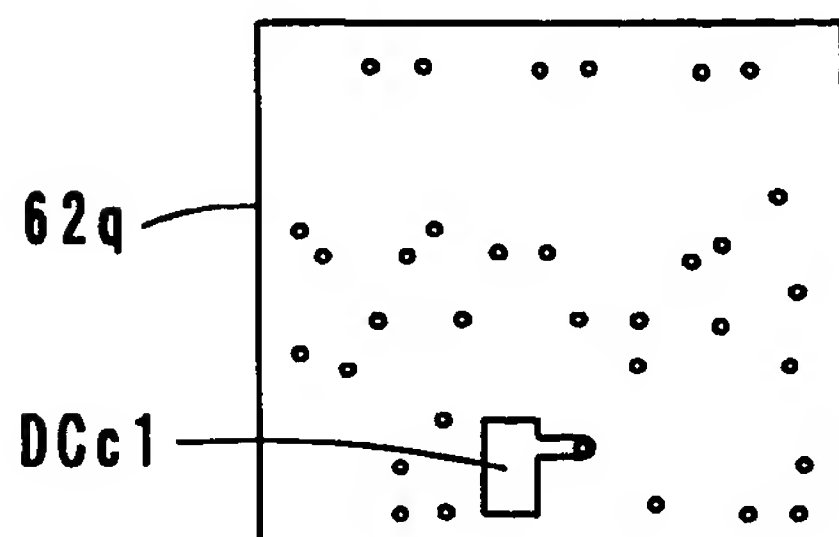
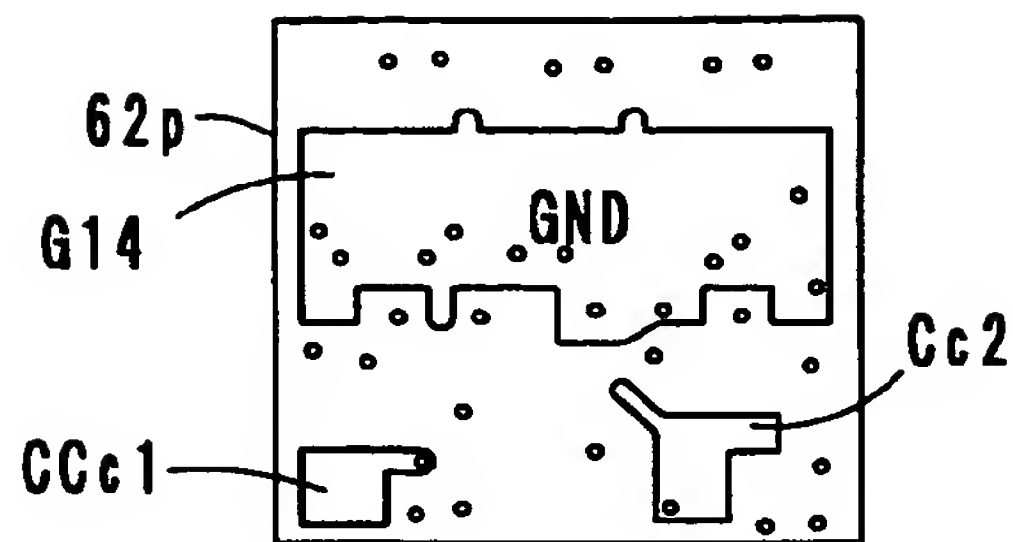


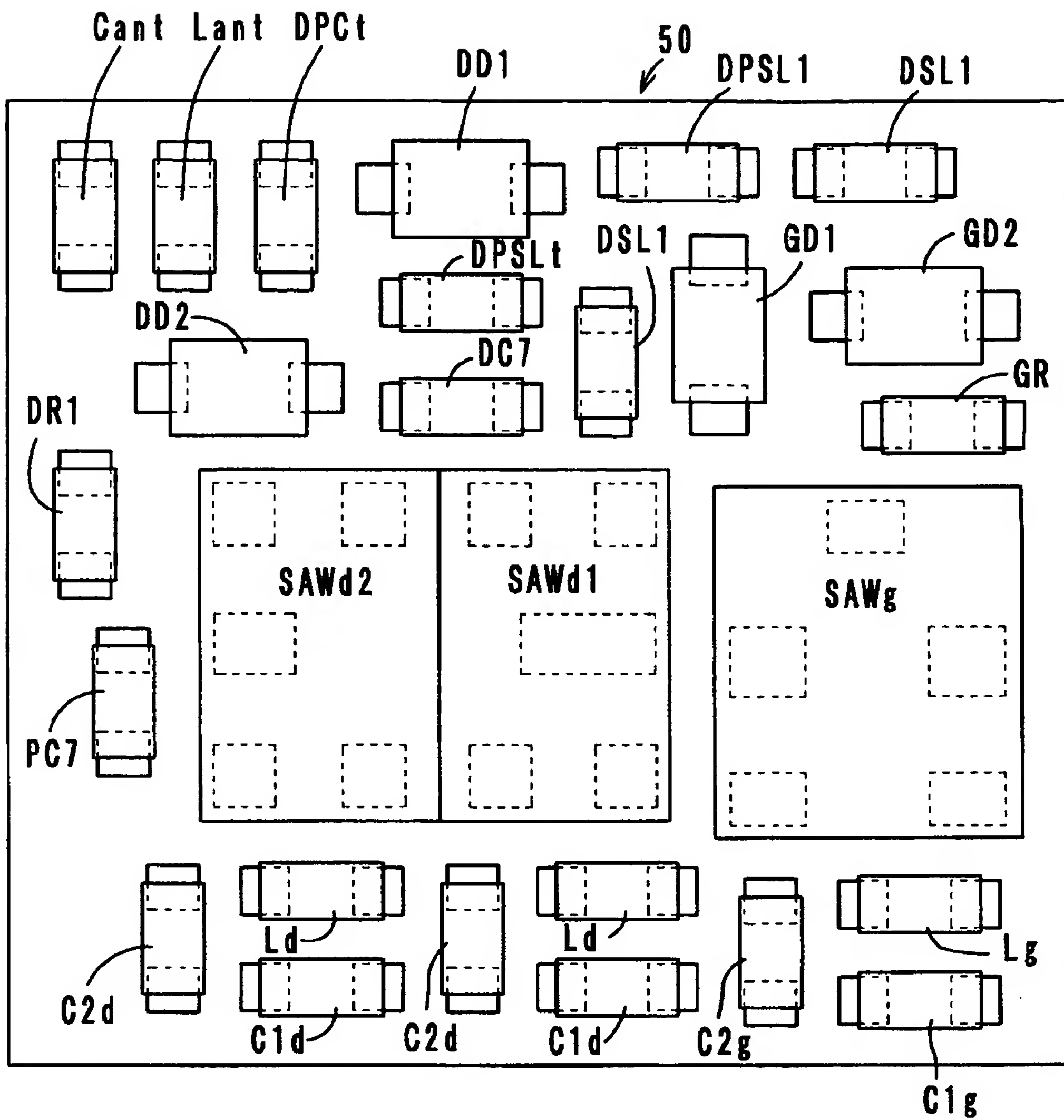




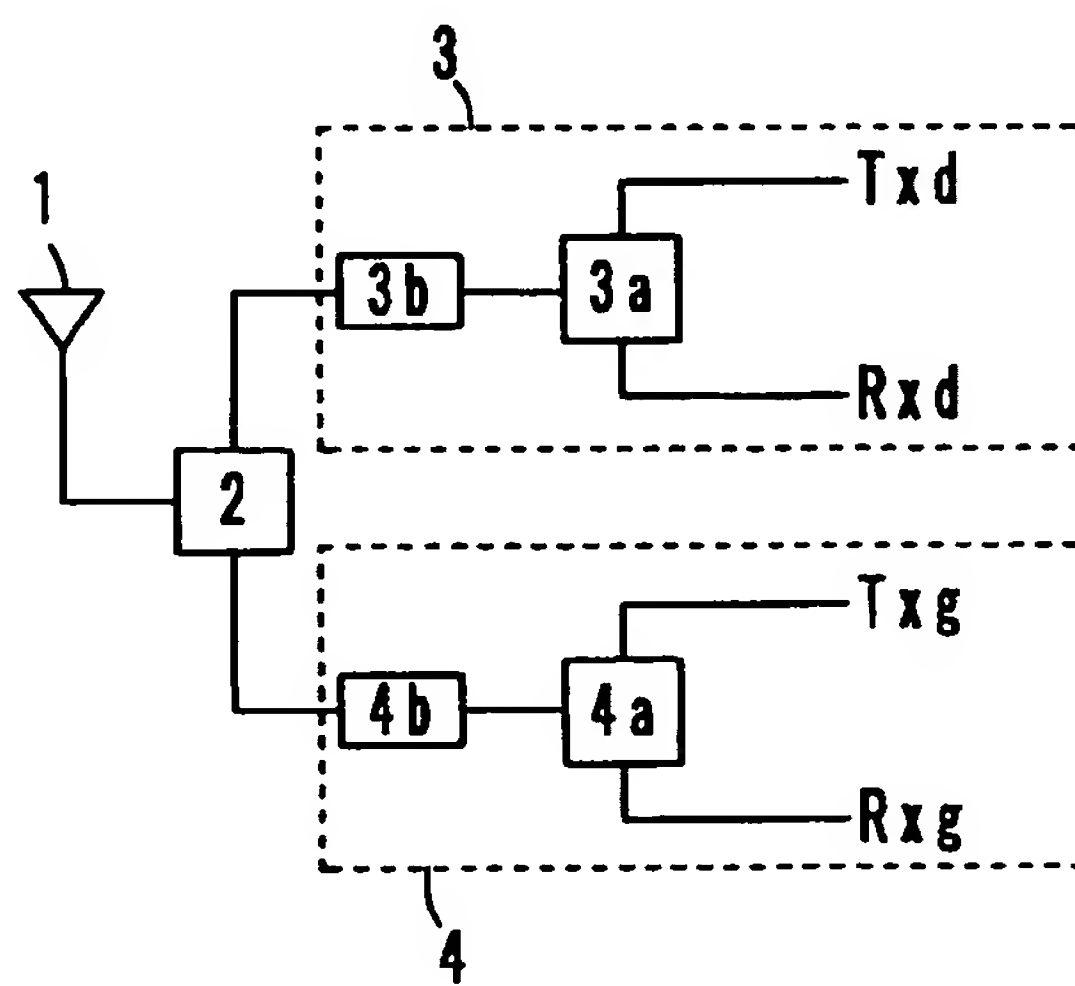


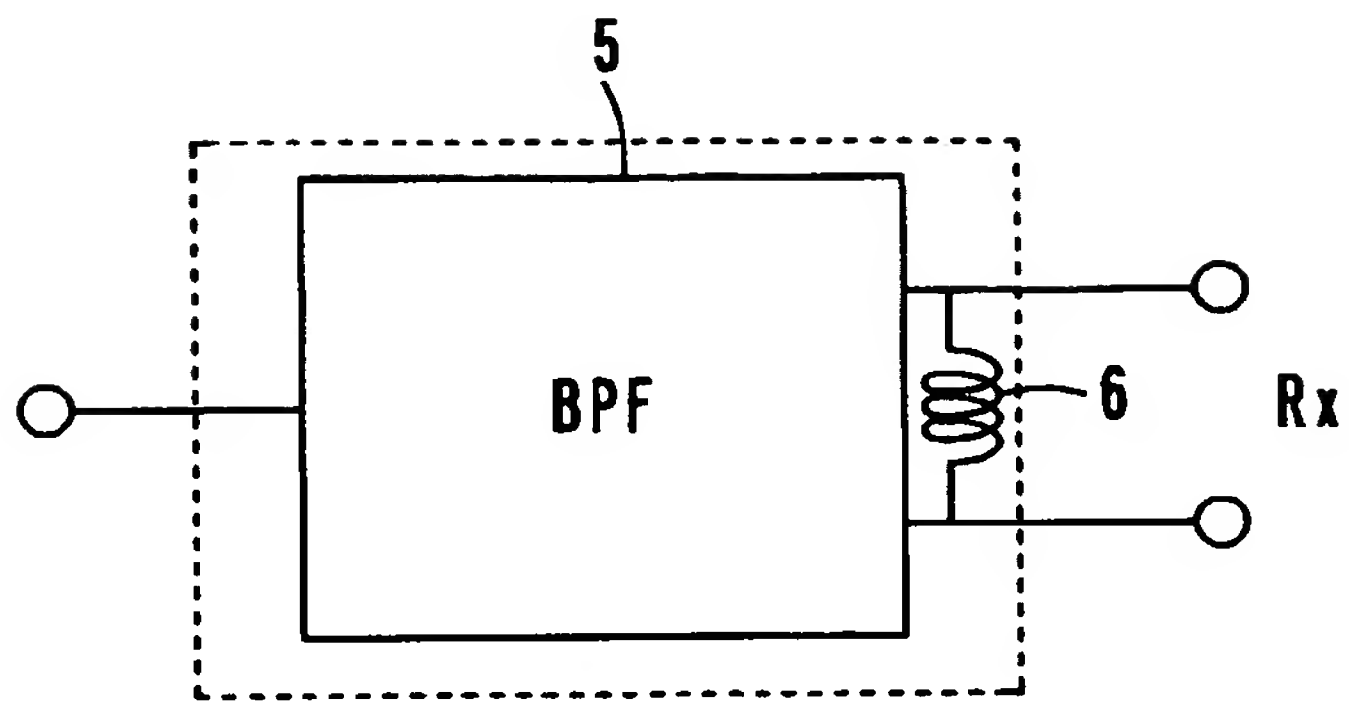






【図 16】





【要約】

【課題】 単体で所望のインピーダンスを容易に設定できてLNAとのマッチング調整が不要で、部品点数の低減、小型化が可能な高周波複合部品を得る。

【解決手段】 アンテナ端子ANTから送受信する信号をGSM系信号経路とDCS系信号経路とにダイプレクサ20で選択的に切り換える高周波複合部品。GSM系及びDCS系には高周波スイッチ11G, 11Dで切り換えられる送信側入力端子Txg, Txdと受信側バランス出力端子Rxg, Rxdを備えている。受信側バランス出力端子Rxg, Rxdと弾性表面波フィルタSAWg, SAWdの出力側との間にインダクタLg, LdとコンデンサC1g, C2g, C1d, C2dからなる整合素子が挿入されている。

【選択図】 図3

2

0 0 0 0 0 6 2 3 1
19900828
新規登録

京都府長岡京市天神二丁目 2 6 番 1 0 号
株式会社村田製作所
0 0 0 0 0 6 2 3 1
20041012
住所変更

京都府長岡京市東神足 1 丁目 1 0 番 1 号
株式会社村田製作所

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/013661

International filing date: 26 July 2005 (26.07.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-231739
Filing date: 06 August 2004 (06.08.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 01 September 2005 (01.09.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse